

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

#5



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2000年 4月24日

出 願 番 号
Application Number:

特願2000-121981

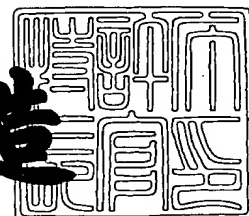
出 願 人
Applicant (s):

富士写真フイルム株式会社

2001年 3月 9日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3015586

【書類名】 特許願

【整理番号】 P25154J

【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【国際特許分類】 G02F 1/37

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡開成町宮台 7 9 8 番地 富士写真フイルム株式会社内

 【氏名】 早川 利郎

【特許出願人】

 【識別番号】 000005201

 【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100073184

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 柳田 征史

【選任した代理人】

 【識別番号】 100090468

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 佐久間 剛

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 008969

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 9814441

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光波長変換モジュール

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 光導波路を有し、該光導波路を導波する基本波を波長変換する光波長変換素子と、

前記基本波としてこの光波長変換素子に入射されるレーザビームを発する半導体レーザと、

この半導体レーザから発せられた後該半導体レーザにフィードバックされるレーザビームを波長選択する波長選択光学素子とからなる光波長変換モジュールにおいて、

前記半導体レーザが多重量子井戸活性層を有し、

この多重量子井戸活性層を構成する複数の量子井戸層のうちの少なくとも一つが、他の量子井戸層と組成および／または厚みが異なることを特徴とする光波長変換モジュール。

【請求項 2】 前記波長選択光学素子として前記半導体レーザと前記光波長変換素子との間に配され、該光波長変換素子の端面で反射して半導体レーザにフィードバックされるレーザビームの波長を選択する透過型の波長選択光学素子が用いられていることを特徴とする請求項 1 記載の光波長変換モジュール。

【請求項 3】 前記光波長変換素子に入射する前の前記レーザビームを一部分岐させる光分岐手段と、

この分岐されたレーザビームを反射させて前記半導体レーザにフィードバックさせる反射部材とが設けられた上で、

前記波長選択光学素子として、前記反射部材と前記半導体レーザとの間のレーザビームの光路に配された透過型の波長選択光学素子が用いられていることを特徴とする請求項 1 記載の光波長変換モジュール。

【請求項 4】 前記光波長変換素子から出射した前記レーザビームを反射させて前記半導体レーザにフィードバックさせる反射部材が設けられた上で、

前記波長選択光学素子として、前記反射部材と前記半導体レーザとの間のレーザビームの光路に配された透過型の波長選択光学素子が用いられていることを特

徴とする請求項 1 記載の光波長変換モジュール。

【請求項 5】 前記光波長変換素子から出射した前記レーザビームと波長変換波とを分岐する光学系が設けられていることを特徴とする請求項 4 記載の光波長変換モジュール。

【請求項 6】 前記半導体レーザから、前記光波長変換素子に向かわない後方出射光として出射したレーザビームを反射させて前記半導体レーザにフィードバックさせる反射部材が設けられた上で、

前記波長選択光学素子として、前記反射部材と前記半導体レーザとの間のレーザビームの光路に配された透過型の波長選択光学素子が用いられていることを特徴とする請求項 1 記載の光波長変換モジュール。

【請求項 7】 前記波長選択光学素子が狭帯域バンドパスフィルターであることを特徴とする請求項 1 から 6 いずれか 1 項記載の光波長変換モジュール。

【請求項 8】 前記狭帯域バンドパスフィルターが薄膜型バンドパスフィルターであることを特徴とする請求項 7 記載の光波長変換モジュール。

【請求項 9】 前記薄膜型バンドパスフィルターが前記半導体レーザの光出射端面に形成されていることを特徴とする請求項 8 記載の光波長変換モジュール。

【請求項 10】 前記透過型の波長選択光学素子が薄膜型の狭帯域バンドパスフィルターであって、このバンドパスフィルターが前記反射部材の表面に形成されていることを特徴とする請求項 3 から 6 いずれか 1 項記載の光波長変換モジュール。

【請求項 11】 前記波長選択光学素子として、前記半導体レーザと前記光波長変換素子との間に配され、前記レーザビームの一部を反射させて半導体レーザにフィードバックするとともに、このフィードバックするレーザビームの波長を選択する反射型の波長選択光学素子が用いられていることを特徴とする請求項 1 記載の光波長変換モジュール。

【請求項 12】 前記波長選択光学素子として、前記光波長変換素子から出射した前記レーザビームを反射させて前記半導体レーザにフィードバックさせるとともに、このフィードバックするレーザビームの波長を選択する反射型の波長

選択光学素子が用いられていることを特徴とする請求項1記載の光波長変換モジュール。

【請求項13】 前記光波長変換素子から出射した前記レーザビームと波長変換波とを分岐する光学系が設けられていることを特徴とする請求項12記載の光波長変換モジュール。

【請求項14】 前記波長選択光学素子として、前記半導体レーザから、前記光波長変換素子に向かわない後方出射光として出射したレーザビームを反射させて前記半導体レーザにフィードバックさせるとともに、このフィードバックするレーザビームの波長を選択する反射型の波長選択光学素子が用いられていることを特徴とする請求項1記載の光波長変換モジュール。

【請求項15】 前記波長選択光学素子がバルクグレーティングであることを特徴とする請求項1から10いずれか1項記載の光波長変換モジュール。

【請求項16】 前記反射型の波長選択光学素子が、コアに複数の屈折率変化部が等間隔に形成された光ファイバーからなるファイバグレーティングであることを特徴とする請求項7から10いずれか1項記載の光波長変換モジュール。

【請求項17】 前記ファイバグレーティングに入射するレーザビームをこのファイバグレーティングのコア端面上で収束させる収束光学系が設けられていることを特徴とする請求項16記載の光波長変換モジュール。

【請求項18】 前記半導体レーザが前記光波長変換素子の端面に結合されていることを特徴とする請求項1から17いずれか1項記載の光波長変換モジュール。

【請求項19】 光導波路を有し、該光導波路を導波する基本波を波長変換する光波長変換素子と、

この光波長変換素子の端面に結合され、前記基本波としてこの光波長変換素子に入射されるレーザビームを発する半導体レーザと、

この半導体レーザの光出射面と前記光波長変換素子の端面との間に配され、該光波長変換素子の端面で反射して半導体レーザにフィードバックするレーザビームの波長を選択する透過型の薄膜狭帯域バンドパスフィルターとからなる光波長

変換モジュールにおいて、

前記半導体レーザが多重量子井戸活性層を有し、

この多重量子井戸活性層を構成する複数の量子井戸層のうちの少なくとも一つが、他の量子井戸層と組成および／または厚みが異なることを特徴とする光波長変換モジュール。

【請求項20】 光導波路を有し、該光導波路を導波する基本波を波長変換する光波長変換素子と、

この光波長変換素子の端面に結合され、前記基本波としてこの光波長変換素子に入射されるレーザビームを発する半導体レーザと、

この半導体レーザの光出射面と前記光波長変換素子の端面との間に配され、前記レーザビームの一部を反射させて半導体レーザにフィードバックするとともに、このフィードバックするレーザビームの波長を選択する反射型の薄膜狭帯域バンドパスフィルターとからなる光波長変換モジュールにおいて、

前記半導体レーザが多重量子井戸活性層を有し、

この多重量子井戸活性層を構成する複数の量子井戸層のうちの少なくとも一つが、他の量子井戸層と組成および／または厚みが異なることを特徴とする光波長変換モジュール。

【請求項21】 基本波としてのレーザビームを発する半導体レーザと、前記レーザビームの波長を選択する導波路型の波長選択光学素子と、前記レーザビームを波長変換する光波長変換素子とが互いに直接結合されてなる光波長変換モジュールにおいて、

前記半導体レーザが多重量子井戸活性層を有し、

この多重量子井戸活性層を構成する複数の量子井戸層のうちの少なくとも一つが、他の量子井戸層と組成および／または厚みが異なることを特徴とする光波長変換モジュール。

【請求項22】 前記波長選択光学素子として反射型のものが用いられ、

この波長選択光学素子と前記光波長変換素子との間に前記半導体レーザが配設されていることを特徴とする請求項21記載の光波長変換モジュール。

【請求項23】 前記波長選択光学素子として反射型のものが用いられ、

この波長選択光学素子と前記半導体レーザとの間に前記光波長変換素子が配設されていることを特徴とする請求項 2 1 記載の光波長変換モジュール。

【請求項 2 4】 前記波長選択光学素子として反射型のものが用いられ、
この波長選択光学素子の前記半導体レーザと反対側の端面が、その光導波路の延びる方向に対して斜めにカットされていることを特徴とする請求項 2 2 または 2 3 記載の光波長変換モジュール。

【請求項 2 5】 前記波長選択光学素子として反射型のものが用いられ、
この波長選択光学素子が、前記半導体レーザと前記光波長変換素子との間に配設されていることを特徴とする請求項 2 1 記載の光波長変換モジュール。

【請求項 2 6】 前記波長選択光学素子が、DBR グレーティングを有するものであることを特徴とする請求項 2 1 から 2 5 いずれか 1 項記載の光波長変換モジュール。

【請求項 2 7】 前記波長選択光学素子として透過型のものが用いられ、
この波長選択光学素子が、前記半導体レーザと、この半導体レーザに向けて光を反射させる反射面を有する光波長変換素子との間に配設されていることを特徴とする請求項 2 1 記載の光波長変換モジュール。

【請求項 2 8】 前記波長選択光学素子が、バンドパスフィルターが挿入された光導波路を有するものであることを特徴とする請求項 2 1 から 2 7 いずれか 1 項記載の光波長変換モジュール。

【請求項 2 9】 前記光波長変換素子が、非線形光学効果を有する強誘電体結晶基板に、その一表面に沿って延びる光導波路が形成されるとともに、この光導波路に基板の自発分極の向きを反転させたドメイン反転部が周期的に形成されてなり、該光導波路を導波する基本波を波長変換するものであることを特徴とする請求項 1 から 2 8 いずれか 1 項記載の光波長変換モジュール。

【請求項 3 0】 前記光波長変換素子が、基本波の導波方向に垂直な面内において、前記基板の自発分極の向きが該基板の前記一表面に対して角度 θ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) をなしているものであることを特徴とする請求項 2 9 記載の光波長変換モジュール。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体レーザから発せられたレーザビームを、光導波路型の光波長変換素子を用いて第2高調波等に変換する光波長変換モジュールに関し、特に詳細には、基本波光源としての半導体レーザの発振波長を波長選択光学素子により選択して、ロックするようにした光波長変換モジュールに関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

従来、例えば特開平10-254001号公報に示されるように、非線形光学効果を有する強誘電体結晶基板に一方方向に延びる光導波路が形成されるとともに、この光導波路に基板の自発分極の向きを反転させたドメイン反転部が周期的に形成されてなり、該光導波路においてドメイン反転部の並び方向に導波する基本波を第2高調波等に波長変換する光波長変換素子が知られている。

【 0 0 0 3 】

また同公報には、この光波長変換素子に、基本波としてのレーザビームを入射させる半導体レーザを結合させてなる光波長変換モジュールも示されている。さらに同公報には、上記半導体レーザに狭帯域バンドパスフィルター等の波長選択光学素子を備えた外部共振器を組み合わせ、この外部共振器の作用によって半導体レーザの発振波長を所望波長にロックする技術も開示されている。

【 0 0 0 4 】

また本出願人による特願平11-345724号明細書には、基本波としてのレーザビームを発する半導体レーザと、このレーザビームの波長を選択する導波路型の波長選択光学素子と、前記レーザビームを波長変換する光波長変換素子とが互いに直接結合されてなる光波長変換モジュールが開示されている。

【 0 0 0 5 】

この光波長変換モジュールにおいては、半導体レーザと直接的にあるいは間に光波長変換素子を介して導波路型の波長選択光学素子が結合されているので、この波長選択光学素子から、光波長変換素子の波長変換部の位相整合波長に選択された光を半導体レーザに戻すことができる。それにより、半導体レーザの発振波

長を選択、ロックして、安定した出力の波長変換波を得ることができる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上記の周期的なドメイン反転部（周期ドメイン反転構造）を有する光波長変換素子を用いた光波長変換モジュールにおいては、基本波光源である半導体レーザの発振波長を、光波長変換素子において波長変換波の位相整合が取られるようになる所定波長に正確にロックする必要がある。また、その他のタイプの光波長変換素子を用いた光波長変換モジュールにおいても、そこから出射する波長変換波の波長を正確に所望値に設定したいという要求が広く存在し、その場合は、基本波光源である半導体レーザの発振波長を所定波長に正確にロックする必要がある。

【0007】

半導体レーザの発振可能波長は半導体レーザ媒質の利得スペクトル幅により決まっているため、製造時に半導体レーザの活性層の組成や厚みを正確に制御して、発振可能波長を所望の発振波長近傍に合わせておく必要がある。

【0008】

また、実際に光波長変換モジュールを作製する際には、波長変換効率、各光学結合の効率、フィルタの透過率等が作製するモジュール毎に異なるため、外部波長ロック系の半導体レーザからみた反射率が変化する。このように反射率が変化すると、発振時の半導体レーザの利得スペクトルもシフトする。一般にはこのシフトが大きいと波長ロックし難くなるが、半導体レーザについては広い波長範囲において波長ロックが可能な方が調整範囲が広がるので望ましい。また、波長ロック範囲が広がるほど、半導体レーザ製造時の活性層の組成や厚みの制御性を緩和することができるため、光波長変換モジュールに適した半導体レーザを歩留まり良く作成可能となる。

【0009】

しかし、基本波光源として半導体レーザを用いた従来の光波長変換モジュールにおいては、半導体レーザの波長ロック可能な範囲が十分に広いとは言えず、そのため、波長ロックの調整作業が煩雑になったり、半導体レーザの活性層の組成

や厚みの制御が困難になるという問題が認められていた。

【 0 0 1 0 】

本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、半導体レーザから発せられた基本波を導波路型の光波長変換素子によって波長変換し、そして該半導体レーザの発振波長を選択、ロックする構成を有する光波長変換モジュールにおいて、半導体レーザの波長ロック可能な範囲を十分に広くすることを目的とする。

【 0 0 1 1 】

【課題を解決するための手段】

本発明による 1 つの光波長変換モジュールは、

前述したように光導波路を有し、該光導波路を導波する基本波を波長変換する光波長変換素子と、

前記基本波としてこの光波長変換素子に入射されるレーザビームを発する半導体レーザと、

この半導体レーザから発せられた後該半導体レーザにフィードバックされるレーザビームを波長選択する波長選択光学素子とからなる光波長変換モジュールにおいて、

前記半導体レーザとして、多重量子井戸活性層を有し、この多重量子井戸活性層を構成する複数の量子井戸層のうちの少なくとも一つが、他の量子井戸層と組成および／または厚みが異なるものが用いられたことを特徴とするものである。

【 0 0 1 2 】

なお、上述の波長選択光学素子としては、例えば半導体レーザと光波長変換素子との間に配され、該光波長変換素子の端面で反射して半導体レーザにフィードバックされるレーザビームの波長を選択する透過型の波長選択光学素子を用いることができる。

【 0 0 1 3 】

あるいは、光波長変換素子に入射する前のレーザビームを一部分岐させる光分岐手段と、

この分岐されたレーザビームを反射させて半導体レーザにフィードバックさせる反射部材とを設けた上で、

波長選択光学素子として、上記反射部材と半導体レーザとの間のレーザビームの光路に配された透過型の波長選択光学素子を用いることもできる。

【 0 0 1 4 】

また、光波長変換素子から出射したレーザビームを反射させて半導体レーザにフィードバックさせる反射部材を設けた上で、波長選択光学素子として、上記反射部材と半導体レーザとの間のレーザビームの光路に配された透過型の波長選択光学素子を用いることもできる。なおその場合は、光波長変換素子から出射したレーザビームと波長変換波とを分岐する光学系を設けることが望ましい。

【 0 0 1 5 】

さらには、半導体レーザから、光波長変換素子に向かわない後方出射光として出射したレーザビームを反射させて該半導体レーザにフィードバックさせる反射部材を設けた上で、

波長選択光学素子として、上記反射部材と半導体レーザとの間のレーザビームの光路に配された透過型の波長選択光学素子を用いることもできる。

【 0 0 1 6 】

以上説明した透過型の波長選択光学素子としてより具体的には、薄膜型バンドパスフィルター等からなる狭帯域バンドパスフィルター等を好適に用いることができる。

【 0 0 1 7 】

そして、上記の薄膜型バンドパスフィルターを適用する場合、その薄膜型バンドパスフィルターは半導体レーザの光出射端面に形成されることが望ましい。またその場合、特に前述の反射部材が設けられる構成においては、その薄膜型狭帯域バンドパスフィルターを該反射部材の表面に形成してもよい。

【 0 0 1 8 】

さらに、上記波長選択光学素子としては、半導体レーザと光波長変換素子との間に配され、レーザビームの一部を反射させて半導体レーザにフィードバックするとともに、このフィードバックするレーザビームの波長を選択する反射型の波長選択光学素子も好適に用いることができる。

【 0 0 1 9 】

また、この波長選択光学素子として、光波長変換素子から出射したレーザビームを反射させて半導体レーザにフィードバックさせるとともに、このフィードバックするレーザビームの波長を選択する反射型の波長選択光学素子を用いることもできる。なおその場合は、光波長変換素子から出射したレーザビームと波長変換波とを分岐する光学系が設けられることが望ましい。

【 0 0 2 0 】

さらに上記波長選択光学素子として、半導体レーザから、光波長変換素子に向かわない後方出射光として出射したレーザビームを反射させて半導体レーザにフィードバックさせるとともに、このフィードバックするレーザビームの波長を選択する反射型の波長選択光学素子も好適に用いることができる。

【 0 0 2 1 】

また上記波長選択光学素子としてより具体的には、バルクグレーティングも好適に用いることができる。

【 0 0 2 2 】

また、上述した反射型の波長選択光学素子としては、コアに複数の屈折率変化部が等間隔に形成された光ファイバーからなるファイバグレーティングを好適に用いることができる。その場合は、ファイバグレーティングに入射するレーザビームをこのファイバグレーティングのコア端面上で収束させる収束光学系が設けられるのが望ましい。

【 0 0 2 3 】

一方、基本波光源としての半導体レーザは、光波長変換素子の端面に結合されることが望ましい。

【 0 0 2 4 】

また、本発明による別の光波長変換モジュールは、
光導波路を有し、該光導波路を導波する基本波を波長変換する光波長変換素子と、

この光波長変換素子の端面に結合され、基本波としてこの光波長変換素子に入射されるレーザビームを発する半導体レーザと、

この半導体レーザの光出射面と上記光波長変換素子の端面との間に配され、該

光波長変換素子の端面で反射して半導体レーザにフィードバックするレーザビームの波長を選択する透過型の薄膜狭帯域バンドパスフィルタとからなる光波長変換モジュールにおいて、

半導体レーザとして、多重量子井戸活性層を有し、この多重量子井戸活性層を構成する複数の量子井戸層のうちの少なくとも一つが、他の量子井戸層と組成および／または厚みが異なるものが用いられたことを特徴とするものである。

【 0 0 2 5 】

また、本発明によるさらに別の光波長変換モジュールは、

光導波路を有し、該光導波路を導波する基本波を波長変換する光波長変換素子と、

この光波長変換素子の端面に結合され、基本波としてこの光波長変換素子に入射されるレーザビームを発する半導体レーザと、

この半導体レーザの光出射面と上記光波長変換素子の端面との間に配され、レーザビームの一部を反射させて半導体レーザにフィードバックするとともに、このフィードバックするレーザビームの波長を選択する反射型の薄膜狭帯域バンドパスフィルタとからなる光波長変換モジュールにおいて、

半導体レーザとして、多重量子井戸活性層を有し、この多重量子井戸活性層を構成する複数の量子井戸層のうちの少なくとも一つが、他の量子井戸層と組成および／または厚みが異なるものが用いられたことを特徴とするものである。

【 0 0 2 6 】

また、本発明によるさらに別の光波長変換モジュールは、

基本波としてのレーザビームを発する半導体レーザと、上記レーザビームの波長を選択する導波路型の波長選択光学素子と、上記レーザビームを波長変換する光波長変換素子とが互いに直接結合されてなる光波長変換モジュールにおいて、

半導体レーザとして、多重量子井戸活性層を有し、この多重量子井戸活性層を構成する複数の量子井戸層のうちの少なくとも一つが、他の量子井戸層と組成および／または厚みが異なるものが用いられたことを特徴とするものである。

【 0 0 2 7 】

この半導体レーザと波長選択光学素子と光波長変換素子とが互いに直接結合さ

れてなる光波長変換モジュールにおいては、波長選択光学素子として反射型のものが用いられ、この波長選択光学素子と光波長変換素子との間に半導体レーザが配設されるのが望ましい。

【 0 0 2 8 】

あるいは、波長選択光学素子として反射型のものが用いられ、この波長選択光学素子と半導体レーザとの間に光波長変換素子が配設されてもよい。

【 0 0 2 9 】

また、上述のように波長選択光学素子として反射型のものが用いられる場合は、この波長選択光学素子の半導体レーザと反対側の端面が、その光導波路の延びる方向に対して斜めにカットされていることが望ましい。

【 0 0 3 0 】

さらに、この半導体レーザと波長選択光学素子と光波長変換素子とが互いに直接結合されてなる光波長変換モジュールにおいては、波長選択光学素子として反射型のものが用いられ、この波長選択光学素子が、半導体レーザと光波長変換素子との間に配設されてもよい。

【 0 0 3 1 】

またこの半導体レーザと波長選択光学素子と光波長変換素子とが互いに直接結合されてなる光波長変換モジュールにおいて、波長選択光学素子としてより具体的には、DBRグレーティングを有するものを好適に用いることができる。

【 0 0 3 2 】

あるいは、この半導体レーザと波長選択光学素子と光波長変換素子とが互いに直接結合されてなる光波長変換モジュールにおいては、波長選択光学素子として透過型のものが用いられ、この波長選択光学素子が、半導体レーザと、この半導体レーザに向けて光を反射させる反射面を有する光波長変換素子との間に配設されてもよい。

【 0 0 3 3 】

さらに、この半導体レーザと波長選択光学素子と光波長変換素子とが互いに直接結合されてなる光波長変換モジュールにおいては、波長選択光学素子として、バンドパスフィルターが挿入された光導波路を有するものも好適に用いることが

できる。

【 0 0 3 4 】

また、以上説明した本発明によるすべての光波長変換モジュールにおいて、光波長変換素子としては、非線形光学効果を有する強誘電体結晶基板に、その一表面に沿って延びる光導波路が形成されるとともに、この光導波路に基板の自発分極の向きを反転させたドメイン反転部が周期的に形成されてなり、該光導波路を導波する基本波を波長変換するものを好適に用いることができる。

【 0 0 3 5 】

そして、そのようなタイプの光波長変換素子を用いる場合、該光波長変換素子は、基本波の導波方向に垂直な面内において、基板の自発分極の向きが該基板の上記一表面に対して角度 θ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) をなしているものであることが好ましい。

【 0 0 3 6 】

【発明の効果】

上述のように多重量子井戸活性層を構成する複数の量子井戸層のうちの少なくとも一つが、他の量子井戸層と組成および／または厚みが異なる構成の半導体レーザは、複数の量子井戸層の組成および／または厚みが全て共通している半導体レーザと比較すると、利得スペクトル幅が拡大したものとなる。

【 0 0 3 7 】

この点について、図 3 8 を参照して説明する。同図の(1)は、多重量子井戸活性層を構成する複数の量子井戸層の厚みが全て共通している場合、同図の(2)はそれらの量子井戸層の厚みが相違する場合の、多重量子井戸活性層全体の利得スペクトルの例を示している。それぞれの場合の利得ピーク波長を λ_2 とし、そこから利得が 20 dB 低下するところの波長、つまり波長選択性の共振器によりレーザ発振可能と考えられる限界の波長を λ_1 、 λ_3 とすると、 λ_1 と λ_3 との差は、同図の(1)の場合は 5 nm 程度、それに対して(2)の場合は 11.5 nm 程度となっている。すなわち(2)の場合は、各量子井戸層の利得スペクトルが互いに相違して多重量子井戸活性層全体の利得スペクトルが拡大している。

【 0 0 3 8 】

なお、多重量子井戸活性層全体の利得スペクトルを拡大させるためには、複数の量子井戸層の厚みを互いに全て相違させる必要はなく、それらの量子井戸層のうちの少なくとも1つの厚みが他の量子井戸層の厚みと異なるようにすればよい。また、そのように量子井戸層の厚みを変える代わりに組成を変えてもよいし、厚みと組成の双方を変えてもよい。

【 0 0 3 9 】

また多重量子井戸活性層としては、2つ以上の井戸数を持つ構造であれば全て適用可能である。井戸数が3つ以上の場合には、組成または厚み、あるいはこの両方ともを、量子井戸層毎に変えることもできる。その場合、ある量子井戸層は組成を、別の量子井戸層では厚みを変える等のことが可能である。

【 0 0 4 0 】

本発明による各光波長変換モジュールにおいては、このように利得スペクトル幅が拡大された半導体レーザを基本波光源として用いたことにより、この半導体レーザの発振波長のロック範囲を十分に広げることができる。そこで本発明による各光波長変換モジュールは、波長ロックの調整作業が容易なものとなり、さらには半導体レーザの活性層の組成や厚みの制御も容易で、生産性が高いものとなり得る。

【 0 0 4 1 】

また、上述のように波長ロック範囲を広くとれば、半導体レーザの絶対波長のばらつき（一般には $\pm 2 \text{ nm}$ 程度）があっても問題を招くことなく、波長が安定した波長変換波を出射する光波長変換モジュールを得ることが可能になる。

【 0 0 4 2 】

なお、前述した周期ドメイン反転構造を有する光波長変換素子を用いる場合、該光波長変換素子が特に、基本波の導波方向に垂直な面内において、基板の自発分極の向きが該基板の一表面に対して角度 θ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) をなしているものであれば、下記の理由により効率良く波長変換がなされ得る。

【 0 0 4 3 】

上記構成を有する光波長変換素子においては、図2に示すように基板16の自発分極の向きつまりZ軸方向が、基板表面16aに対して垂直にはなっていないので

、半導体レーザ100から出射したレーザビーム11をその直線偏光方向（矢印Q方向）が基板表面16aと平行となる状態で光導波路18に入射させても、最大の非線形光学定数 d_{33} が有効に利用されて波長変換が可能となる。なおこの場合、レーザビーム11の電界ベクトルの向きは基板表面16aと平行な向きとなり、該レーザビーム11は光導波路18をTEモードで導波する。そのときの実効的な非線形光学定数は $d_{33} \cos \theta$ となる。

【0044】

上記のように、レーザビーム11をその直線偏光方向が基板表面16aと平行となる状態で光導波路18に入射させるのであれば、直線偏光方向を回転させる $\lambda/2$ 板等は不要で基本波入射光学系は簡単なものとなり、半導体レーザ100を光導波路18の端面に直接結合することも可能となる。また、レーザビーム11をこのようにして光導波路18に入射させる場合は、レーザビーム11の光導波路18への入力効率も高くなる。

【0045】

なお角度 θ の好ましい範囲やその理由に関しては、特開平10-254001号公報に詳しい説明がなされている。

【0046】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図1は、本発明の第1の実施形態による光波長変換モジュールを示すものであり、図2はその一部を概略的に示すものである。

【0047】

図示されるようにこの光波長変換モジュールは、発振波長946nm程度の基本横モードレーザである半導体レーザ（レーザダイオード）100と、この半導体レーザ100から発散光状態で出射したレーザビーム11を平行光化するコリメーターレンズ12と、平行光化されたレーザビーム11を収束させる集光レンズ13と、これらのレンズ12および13の間に配された波長選択光学素子としての狭帯域バンドパスフィルター14と、光波長変換素子15とを有している。

【0048】

まず図3を参照して、基本波光源としての半導体レーザ100について、その作製法も併せて説明する。減圧MOCVD成長法により、n-GaAs基板121($\text{Si}=2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ドープ)上にn-GaAsバッファ層122($\text{Si}=5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ドープ、 $0.5 \mu\text{m}$)、n- $\text{In}_{0.48}\text{Ga}_{0.52}\text{P}$ クラッド層123($\text{Si}=5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ドープ、 $1.5 \mu\text{m}$)、 $\text{In}_{0.13}\text{Ga}_{0.87}\text{As}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 光ガイド層124(下部 $0.4 \mu\text{m}$ は $\text{Si}=8 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ドープ、上部 $0.05 \mu\text{m}$ はアンドープ、計 $0.45 \mu\text{m}$)、MQW(多重量子井戸)活性層125(アンドープ、 7 nm)、 $\text{In}_{0.13}\text{Ga}_{0.87}\text{As}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 光ガイド層126(アンドープ、 $0.1 \mu\text{m}$)、n- $\text{In}_{0.48}(\text{Ga}_{0.7}\text{Al}_{0.3})_{0.52}\text{P}$ 電流狭窄層127($\text{Si}=2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ドープ、 $0.8 \mu\text{m}$)、n- $\text{In}_{0.48}\text{Ga}_{0.52}\text{P}$ 層128($\text{Si}=2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ドープ、 10 nm)を順次積層する。

【0049】

次にフォトリソグラフィ工程とHClを用いて、n- $\text{In}_{0.48}\text{Ga}_{0.52}\text{P}$ 層128およびn- $\text{In}_{0.48}(\text{Ga}_{0.7}\text{Al}_{0.3})_{0.52}\text{P}$ 電流狭窄層127に幅 $W=2.5 \mu\text{m}$ のストライプ状溝を形成する。このエッチングは選択的に $\text{In}_{0.13}\text{Ga}_{0.87}\text{As}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 光ガイド層126上で停止する。次に2回目のMOCVD成長法により、p- $\text{In}_{0.48}\text{Ga}_{0.52}\text{P}$ クラッド層129($\text{Zn}=7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ドープ、 $1 \mu\text{m}$)、p-GaAsキャップ層130($\text{Zn}=2 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ ドープ、 $0.1 \mu\text{m}$)を順次積層する。

【0050】

次に、n-GaAs基板121の底面を研磨して、全体の厚みが $100 \mu\text{m}$ 程度になるまで薄くし、p側電極131(Ti/Pt/Au)、n側電極132(AuGe/Ni/Au)を蒸着および熱処理により形成する。後は通常と同様のプロセスにてバー切り出し、端面コーティング、チップ切り出しを行なうと、半導体レーザ100が完成する。

【0051】

この半導体レーザ100は以上説明した通り、n-GaAs基板121、n-GaAsバッファ層122、n- $\text{In}_{0.48}\text{Ga}_{0.52}\text{P}$ クラッド層123、 $\text{In}_{0.13}\text{Ga}_{0.87}\text{As}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 光ガイド層124、MQW活性層125、 $\text{In}_{0.13}\text{Ga}_{0.87}\text{As}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 光ガイド層126、n- $\text{In}_{0.48}(\text{Ga}_{0.7}\text{Al}_{0.3})_{0.52}\text{P}$ 電流狭窄層

127、 $n\text{-In}_{0.48}\text{Ga}_{0.52}\text{P}$ 層128、 $p\text{-In}_{0.48}\text{Ga}_{0.52}\text{P}$ クラッド層129、 $p\text{-GaAs}$ キャップ層130、 p 側電極131および n 側電極132を備えてなる。

【 0 0 5 2 】

上記構成の半導体レーザ100は、劈開された両端面に30%程度の反射率となるようにコーティングを施すと、946 nm程度の波長にて発振する。この半導体レーザ100のMQW活性層125は、 $\text{GaAs}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 障壁層(9 nm)、 $\text{In}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{As}$ 量子井戸層(5.6 nm)、 $\text{In}_{0.13}\text{Ga}_{0.87}\text{As}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 障壁層(4 nm)、 $\text{In}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{As}$ 量子井戸層(6 nm)、 $\text{In}_{0.13}\text{Ga}_{0.87}\text{As}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 障壁層(4 nm)、 $\text{In}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{As}$ 量子井戸層(6.4 nm) および $\text{GaAs}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 障壁層(9 nm)を有する重量子井戸構造のものであり、3つの量子井戸層の厚みは互いに異なっている。

【 0 0 5 3 】

光波長変換素子15は、非線形光学効果を有する強誘電体である LiNbO_3 に MgO が例えば5 mol%ドーピングされたもの(以下、 MgO-LN と称する)の結晶からなる基板16に、その Z 軸と平行な自発分極の向きを反転させたドメイン反転部17が周期的に形成されてなる周期ドメイン反転構造と、この周期ドメイン反転構造に沿って延びるチャンネル光導波路18が形成されてなるものである。

【 0 0 5 4 】

周期ドメイン反転構造は、基板16の X 軸方向にドメイン反転部17が並ぶように形成され、その周期 Λ は、 MgO-LN の屈折率の波長分散を考慮し、980 nm近辺の波長に対して1次の周期となるように5.3 μm とされている。このような周期ドメイン反転構造は、例えば特開平6-242478号公報に示される方法によって形成することができる。

【 0 0 5 5 】

一方チャンネル光導波路18は、周期ドメイン反転部17を形成した後、基板16の $+Z$ 面上に公知のフォトリソグラフィーとリフトオフにより金属マスクパターンを形成し、この基板16をピロリン酸中に浸漬してプロトン交換処理を行ない、マスクを除去した後にアニール処理する、等の方法によって作成することができる。その後このチャンネル光導波路18の両端面18a、18bをエッジ研磨すると、光

波長変換素子15が完成する。

【 0 0 5 6 】

以下図4、5および6を参照して、光波長変換素子15の製造方法を詳しく説明する。図4中の16は、上記MgO-LNの結晶からなる基板である。このMgO-LN基板16は、図5に示すようにMgO-LNのインゴット16'を、Y軸をYZ面内でZ軸側に 3° 回転させた軸に対して垂直な面でカット、研磨して得られたものであり、単分極化処理がなされて例えば厚さ0.3 mmに形成されている。なお、この研磨角度 $\theta = 3^\circ$ の精度は $\pm 0.1^\circ$ である。

【 0 0 5 7 】

以上のように形成されたMgO-LN基板16の表面16a、16bと平行でX軸と直交する方向、および基板表面16a、16bに対して垂直な方向はそれぞれ、Z軸方向およびY軸方向に対して角度 $\theta = 3^\circ$ をなす方向となるので、これらの方向を便宜的にそれぞれZ'方向、Y'方向と称する。

【 0 0 5 8 】

上記MgO-LN基板16の表面16a、16bに、図4のようにそれぞれ櫛形電極80、平板電極81を取り付け、+Z側に位置する櫛形電極80の方が正電位、-Z側に位置する平板電極81の方が負電位となるようにして、両電極80、81間にパルス電圧を印加すると、図6に概略図示するように、+Z方向を向いていた基板16の自発分極の向きが電圧印加部分において反転して、ドメイン反転部17が形成される。なお上記自発分極の向きは、基板表面16aに対して $\theta = 3^\circ$ 傾いており、したがってドメイン反転部17の分極の向きも基板表面16aに対して同様に傾くことになる。

【 0 0 5 9 】

本例では、櫛形電極80および平板電極81をCrから形成したが、MgO-LN基板16よりも電気抵抗が十分低い材料ならば何でも電極材料として用いることができる。櫛形電極80および平板電極81は周知のフォトリソグラフィによって形成することができ、厚さは例えば20~100 μm 、長さ L_1 は例えば6 mm、両電極80、81間のギャップGは例えば100~500 μm とすればよい。また櫛形電極80の周期 Λ は4.75 μm 、電極指の長さおよび幅はそれぞれ1000 μm 、0.5 μm と

した。そして平板電極81の幅、すなわちZ' 方向の寸法は100 μm とした。

【0060】

上記の電圧印加は、電流のリークを防止するために真空中で行なった。このときの真空度は、例えば 5×10^{-5} Torr以下とする。なお、このように真空中で電圧印加する代わりに、絶縁オイル中で電圧印加するようにしてもよい。また印加電圧のパルス幅は、1～10sec とすればよい。

【0061】

各ドメイン反転部17は、印加電圧が大きい程Z軸と垂直な方向に大きく広がるようになる。周知のように、周期ドメイン反転構造を利用して波長変換する場合の波長変換効率、ドメイン反転部17と非反転部との導波方向の長さの比が1：1のときに最大となる。この比が1：1となるのは、例えば上記ギャップGが200 μm の場合は印加電圧を約4000Vにしたとき、ギャップGが400 μm の場合は印加電圧を約3500Vにしたときである。これらの最適電圧の値は、基板温度を室温に設定した場合のものであり、基板温度を例えば200 $^{\circ}\text{C}$ とすると、各場合の最適電圧は約1／3となる。

【0062】

なお以上は、基板の表と裏に電極を形成してドメイン反転部を形成した例であるが、基板の表のみに電極を設けても、同様の深いドメイン反転部が得られる。この場合、電極形成プロセスを基板の表に対して行なうだけでよいので、素子製造プロセスが簡便になって、より望ましい。

【0063】

次に上記MgO-LN基板16に、以下のようにしてチャンネル光導波路18を形成した。まず、ドメイン反転が最も深くなっている櫛形電極80の先端近傍に、周知のフォトリソグラフィにより、Z' 方向の幅が5～9 μm 程度の金属（本例ではTa）のマスクを形成する。その後このMgO-LN基板16に対して、ピロリン酸中で160 $^{\circ}\text{C}$ で64分間プロトン交換処理を行ない、Taマスクをエッチング液で除去した後、大気中において350 $^{\circ}\text{C}$ で1時間アニールする。以上の処理により、図1および2に示すように、ドメイン反転部17の並び方向に沿って延びるチャンネル光導波路18が形成される。

【 0 0 6 4 】

次に上記MgO-LN基板16の、チャンネル光導波路18の端面を含む-X面および+X面を光学研磨すると、光波長変換素子15が完成する。

【 0 0 6 5 】

そして図1に示すように、半導体レーザ100から発せられた中心波長946 nmのレーザビーム11を集光レンズ13により集光して、チャンネル光導波路18の端面18aにおいて収束させる。それにより、この基本波としてのレーザビーム11がチャンネル光導波路18内に入射する。このレーザビーム11はチャンネル光導波路18をTEモードで導波し、その周期ドメイン反転領域で位相整合（いわゆる疑似位相整合）して、波長が1/2つまり473 nmの青色の第2高調波19に波長変換される。この第2高調波19もチャンネル光導波路18を導波モードで伝搬し、光導波路端面18bから出射する。

【 0 0 6 6 】

光導波路端面18bからは、波長変換されなかったレーザビーム11も発散光状態で出射し、第2高調波19とともにコリメーターレンズ20によって平行光化される。第2高調波19は、図示しないバンドパスフィルターやダイクロイックミラー等によってレーザビーム11と分離され、所定の用途に用いられる。

【 0 0 6 7 】

上記の光波長変換モジュールにおいては、MgO-LN基板16の自発分極の向きつまりZ軸方向が、基板表面16aに対して垂直にはなっていないので、半導体レーザ100から出射したレーザビーム11をその直線偏光方向（矢印Q方向）が基板表面16aと平行となる状態で光導波路18に入射させても、非線形光学定数 d_3 が利用されて波長変換が可能となる。なおこの場合、レーザビーム11についての出射ビームパターンと導波ビームパターンは一致し、ビームパターンのミスマッチがないため、該レーザビーム11を高効率で光導波路18に入力させることができる。そこで、発生する第2高調波19の強度が高くなる。レーザビーム11は光導波路18をTEモードで導波し、このときの実効的な非線形光学定数は $d_3 \cos \theta$ となる。

【 0 0 6 8 】

この場合の波長変換の換算効率 $は 180 \% / W c m^2$ であり、例えば文献 Technical Digest Of The Fourth Microoptics Conference And The Eleventh Topical Meeting On Gradient-index Optical Systems p.154等に記載されている、X または Y カットの $LiTaO_3$ 基板に光導波路および周期ドメイン反転構造を形成してなる従来の光波長変換素子の換算効率 $55 \% / W c m^2$ 等と比べて、著しく高いものとなっている。

【 0 0 6 9 】

本実施形態においてはチャンネル光導波路18の端面18aに、中心波長946 nm のレーザビーム11を一部反射させる所定のコーティングが施され、該端面18aで反射したレーザビーム11が半導体レーザ100にフィードバックされる。つまりこの装置では、上記光導波路端面18aと半導体レーザ100の後方端面（図1中の左方の端面）によって半導体レーザ100の外部共振器が構成されている。

【 0 0 7 0 】

そしてこの外部共振器の中に配された狭帯域バンドパスフィルター14により、そこを透過するレーザビーム11の波長が選択される。半導体レーザ100はこの選択された波長で発振し、選択波長は狭帯域バンドパスフィルター14の回転位置（図1中の矢印A方向の回転位置）に応じて変化するので、この狭帯域バンドパスフィルター14を適宜回転させることにより、半導体レーザ100の発振波長を、ドメイン反転部17の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【 0 0 7 1 】

そして本実施形態においては、半導体レーザ100のMQW活性層125の3つの量子井戸層の厚みがそれぞれ5.6 nm、6 nm、6.4 nmと互いに異なるため、各量子井戸層の利得スペクトルが互いに相違して（利得ピークのズレ幅は互いに5 nm程度である）MQW活性層125の全体の利得スペクトルが拡大し、より広い波長範囲において発振波長の選択、ロックが可能となっている。本例では、波長ロックによりサイドモード抑圧比25 dB以上の単一モード発振が可能となっている。

【 0 0 7 2 】

なお、MQW活性層125の全体の利得スペクトルを拡大させるためには、MQW活性層125の複数の量子井戸層のうちの少なくとも1つの厚みを他の量子井戸層の厚

みと変える他、それら複数の量子井戸層のうちの少なくとも1つの組成を、あるいは組成および厚みを他の量子井戸層の組成と変えるようにしてもよい。

【 0 0 7 3 】

次に図7を参照して、本発明の第2の実施形態について説明する。なおこの図7において、図1および2中のものと同等の要素には同番号を付し、それらについての重複した説明は省略する（以下、同様）。

【 0 0 7 4 】

この第2の実施形態においては、コリメーターレンズ12と集光レンズ13との間にビームスプリッタ82が設けられ、光波長変換素子15に向かうレーザビーム11がこのビームスプリッタ82により一部分岐される。分岐されたレーザビーム11は狭帯域バンドパスフィルター14を透過した後、集光レンズ84によって収束し、その収束位置に配されたミラー85において反射する。

【 0 0 7 5 】

反射したレーザビーム11は、それまでの光路を逆に辿って半導体レーザ100にフィードバックされる。つまりこの装置では、上記ミラー85と半導体レーザ100の後方端面（図7中の左方の端面）によって半導体レーザ100の外部共振器が構成されている。

【 0 0 7 6 】

そしてこの外部共振器の中に配された狭帯域バンドパスフィルター14により、フィードバックされるレーザビーム11の波長が選択される。半導体レーザ100はこの選択された波長で発振し、選択波長は狭帯域バンドパスフィルター14の回転位置（図7中の矢印A方向の回転位置）に応じて変化するので、この狭帯域バンドパスフィルター14を適宜回転させることにより、半導体レーザ100の発振波長を、ドメイン反転部17の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【 0 0 7 7 】

次に図8を参照して、本発明の第3の実施形態について説明する。この第3の実施形態において、光波長変換素子15の光導波路端面18bから出射した第2高調波19および、波長変換されなかったレーザビーム11は、コリメーターレンズ20に

よって平行光化される。平行光化された第 2 高調波 19 はダイクロイックミラー 21 で反射し、利用位置に導かれる。一方波長変換されなかったレーザビーム 11 はダイクロイックミラー 21 および狭帯域バンドパスフィルター 14 を透過し、集光レンズ 22 により集光されてミラー 85 上において収束する。

【 0 0 7 8 】

ミラー 85 で反射したレーザビーム 11 は、それまでの光路を逆に辿って半導体レーザ 100 にフィードバックされる。つまりこの装置では、上記ミラー 85 と半導体レーザ 100 の後方端面（図 8 中の左方の端面）によって半導体レーザ 100 の外部共振器が構成されている。

【 0 0 7 9 】

そしてこの場合も、狭帯域バンドパスフィルター 14 を矢印 A 方向に適宜回転させることにより、半導体レーザ 100 の発振波長を、ドメイン反転部 17 の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【 0 0 8 0 】

次に図 9 を参照して、本発明の第 4 の実施形態について説明する。この第 4 の実施形態においては、光波長変換素子 15 に向かわないレーザビーム 11 R（後方出射光）が、コリメーターレンズ 86 によって平行光化される。平行光化されたレーザビーム 11 R は狭帯域バンドパスフィルター 14 を透過した後、集光レンズ 84 により集光されてミラー 85 上において収束する。

【 0 0 8 1 】

ミラー 85 で反射したレーザビーム 11 R は、それまでの光路を逆に辿って半導体レーザ 100 にフィードバックされる。つまりこの装置では、上記ミラー 85 と半導体レーザ 100 の前方端面（図 9 中の右方の端面）によって半導体レーザ 100 の外部共振器が構成されている。

【 0 0 8 2 】

そしてこの外部共振器の中に配された狭帯域バンドパスフィルター 14 により、フィードバックされるレーザビーム 11 R の波長が選択される。半導体レーザ 100 はこの選択された波長で発振し、選択波長は狭帯域バンドパスフィルター 14 の回転位置（図 9 中の矢印 A 方向の回転位置）に応じて変化するので、この狭帯域バ

ンドパスフィルタ-14を適宜回転させることにより、半導体レーザ100の発振波長を、ドメイン反転部17の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【 0 0 8 3 】

次に図10を参照して、本発明の第5の実施形態について説明する。この第5の実施形態の光波長変換モジュールは、図1に示したものと比べると、狭帯域バンドパスフィルタ-14に代えて透過型のバルクグレーティング90が用いられている点が異なるものである。このバルクグレーティング90も波長選択光学素子として機能するものであり、それを矢印A方向に適宜回転させることにより、半導体レーザ100の発振波長を、ドメイン反転部17の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【 0 0 8 4 】

なおこの透過型のバルクグレーティング90は、図7、8および9図に示した各構成においても、狭帯域バンドパスフィルタ-14に代えて用いることができ、そのようにした場合も上記と同様の作用、効果を奏するものである。

【 0 0 8 5 】

次に図11を参照して、本発明の第6の実施形態について説明する。この第6の実施形態の光波長変換モジュールは、図1に示したものと比べると、狭帯域バンドパスフィルタ-14に代えて、透過型の狭帯域薄膜バンドパスフィルタ-91が用いられた点が異なるものである。この狭帯域薄膜バンドパスフィルタ-91は、半導体レーザ100の光出射端面100a上に形成されている。

【 0 0 8 6 】

この狭帯域薄膜バンドパスフィルタ-91は、薄膜の構成に応じた波長の光を選択的に透過させるものである。このような狭帯域薄膜バンドパスフィルタ-91を、光波長変換素子15の光導波路端面18aと半導体レーザ100の後方端面（図11中の左方の端面）によって構成される半導体レーザ100の外部共振器中に配したことにより、半導体レーザ100の発振波長を、ドメイン反転部17の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【 0 0 8 7 】

次に図 1 2 を参照して、本発明の第 7 の実施形態について説明する。この第 7 の実施形態の光波長変換モジュールは、図 1 1 に示したものと比べると、透過型の狭帯域薄膜バンドパスフィルター 91 の配置位置が異なるものである。すなわちこの場合は、光波長変換素子 15 の光導波路端面 18 a を含む端面上に狭帯域薄膜バンドパスフィルター 91 が形成されている。

【 0 0 8 8 】

この実施形態でも、狭帯域薄膜バンドパスフィルター 91 を、光波長変換素子 15 の光導波路端面 18 a と半導体レーザ 100 の後方端面（図 1 2 中の左方の端面）によって構成される半導体レーザ 100 の外部共振器中に配したことにより、半導体レーザ 100 の発振波長を、ドメイン反転部 17 の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【 0 0 8 9 】

次に図 1 3 を参照して、本発明の第 8 の実施形態について説明する。この第 8 の実施形態の光波長変換モジュールは、図 1 2 に示したものと比べると、コリメーターレンズ 12 および集光レンズ 13 を省いた上で、半導体レーザ 100 の光出射端面 100 a を、透過型の狭帯域薄膜バンドパスフィルター 91 を介して光波長変換素子 15 に直接的に結合した点が異なるものである。

【 0 0 9 0 】

この実施形態でも、狭帯域薄膜バンドパスフィルター 91 を、光波長変換素子 15 の光導波路端面 18 a と半導体レーザ 100 の後方端面（図 1 3 中の左方の端面）によって構成される半導体レーザ 100 の外部共振器中に配したことにより、半導体レーザ 100 の発振波長を、ドメイン反転部 17 の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【 0 0 9 1 】

またこの第 8 の実施形態の光波長変換モジュールは、基本波を光波長変換素子に入射させる入射光学系が不要であるため、構成が簡単で、また光学的な調整も極めて容易なものとなる。

【 0 0 9 2 】

上記のように半導体レーザ 100 を光波長変換素子 15 に結合する場合、透過型の

狭帯域薄膜バンドパスフィルター91は半導体レーザ100と光波長変換素子15との間に限らず、例えば、光波長変換素子15の光導波路端面18bを含む端面上等に形成することも可能である。

【 0 0 9 3 】

さらに、半導体レーザ100を光波長変換素子15に結合する場合、波長選択光学素子は上記透過型の狭帯域薄膜バンドパスフィルター91に限られるものではないことは勿論である。例えば前述した図8の構成において、レンズ12および13を省いて半導体レーザ100を光波長変換素子15に直接結合することもできる。

【 0 0 9 4 】

次に図14を参照して、本発明の第9の実施形態について説明する。この第9の実施形態の光波長変換モジュールは、図8に示したものと比べると、狭帯域バンドパスフィルター14に代えて、透過型の狭帯域薄膜バンドパスフィルター91が用いられた点が異なるものである。この狭帯域薄膜バンドパスフィルター91は、光波長変換素子15の光導波路端面18bを含む端面上に形成されている。

【 0 0 9 5 】

この実施形態でも、狭帯域薄膜バンドパスフィルター91を、ミラー85と半導体レーザ100の後方端面（図14中の左方の端面）によって構成される半導体レーザ100の外部共振器中に配したことにより、半導体レーザ100の発振波長を、ドメイン反転部17の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【 0 0 9 6 】

次に図15を参照して、本発明の第10の実施形態について説明する。この第10の実施形態の光波長変換モジュールは、図9に示したものと比べると、狭帯域バンドパスフィルター14に代えて、透過型の狭帯域薄膜バンドパスフィルター91が用いられた点が異なるものである。この狭帯域薄膜バンドパスフィルター91は、ミラー85の反射面上に形成されている。

【 0 0 9 7 】

この実施形態でも、狭帯域薄膜バンドパスフィルター91を、ミラー85と半導体レーザ100の前方端面（図15中の右方の端面）によって構成される半導体レーザ100の外部共振器中に配したことにより、半導体レーザ100の発振波長を、ドメ

イン反転部17の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【 0 0 9 8 】

なお以上説明した透過型の狭帯域薄膜バンドパスフィルタ-91は、図7の構成において狭帯域バンドパスフィルタ-14に代えて用いることも勿論可能である。その場合、狭帯域薄膜バンドパスフィルタ-91は、例えばミラー85の反射面や、半導体レーザ100の前方端面（図7中の右方の端面）の上に形成すればよい。

【 0 0 9 9 】

次に図16を参照して、本発明の第11の実施形態について説明する。この第11の実施形態の光波長変換モジュールは、図7に示したものと比べると、ミラー85に代えて反射型のバルクグレーティング92が設けられ、そして狭帯域バンドパスフィルタ-14が省かれた点が異なるものである。

【 0 1 0 0 】

上記反射型のバルクグレーティング92は、そこに入射したレーザビーム11を反射させる。つまりこの装置では、このバルクグレーティング92と半導体レーザ100の後方端面（図16中の左方の端面）によって半導体レーザ100の外部共振器が構成されている。またこのバルクグレーティング92は波長選択光学素子として機能するものであり、それを矢印A方向に適宜回転させることにより、半導体レーザ100の発振波長を、ドメイン反転部17の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【 0 1 0 1 】

次に図17を参照して、本発明の第12の実施形態について説明する。この第12の実施形態の光波長変換モジュールは、図8に示したものと比べると、ミラー85に代えて反射型のバルクグレーティング92が設けられ、そして狭帯域バンドパスフィルタ-14が省かれた点が異なるものである。

【 0 1 0 2 】

上記反射型のバルクグレーティング92は、そこに入射したレーザビーム11を反射させる。つまりこの装置では、このバルクグレーティング92と半導体レーザ100の後方端面（図17中の左方の端面）によって半導体レーザ100の外部共振器が構成されている。またこのバルクグレーティング92は波長選択光学素子として機

能するものであり、それを矢印A方向に適宜回転させることにより、半導体レーザー100の発振波長を、ドメイン反転部17の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【0103】

次に図18を参照して、本発明の第13の実施形態について説明する。この第13の実施形態の光波長変換モジュールは、図9に示したものと比べると、ミラー85に代えて反射型のバルクグレーティング92が設けられ、そして狭帯域バンドパスフィルター14が省かれた点が異なるものである。

【0104】

上記反射型のバルクグレーティング92は、そこに入射したレーザービーム11を反射させる。つまりこの装置では、このバルクグレーティング92と半導体レーザー100の前方端面（図18中の右方の端面）によって半導体レーザー100の外部共振器が構成されている。またこのバルクグレーティング92は波長選択光学素子として機能するものであり、それを矢印A方向に適宜回転させることにより、半導体レーザー100の発振波長を、ドメイン反転部17の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【0105】

なお、以上説明したような反射型のバルクグレーティング92に代えて、反射型の狭帯域薄膜バンドパスフィルターを用いることもできる。そのように形成された本発明の第14の実施形態を、図19を参照して説明する。この第14の実施形態の光波長変換モジュールは、図18に示したものと比べると、コリメーターレンズ86、集光レンズ84および反射型のバルクグレーティング92を省いて、半導体レーザー100の後方端面100bに反射型の狭帯域薄膜バンドパスフィルター95を形成した点が異なるものである。

【0106】

なお勿論ながら、上記図19の構成においてレンズ12および13を省いて、半導体レーザー100を光波長変換素子15に直接結合するようなことも可能である。

【0107】

次に図20を参照して、本発明の第15の実施形態について説明する。この第

15の実施形態の光波長変換モジュールは、図17に示したものと比べると、バルクグレーティング92に代えてファイバグレーティング23が設けられている点異なるものである。

【0108】

光波長変換素子15の光導波路端面18bからは、波長変換されなかったレーザービーム11も発散光状態で出射し、コリメーターレンズ20によって平行光化される。平行光化された第2高調波19はダイクロイックミラー21で反射し、利用位置に導かれる。一方波長変換されなかったレーザービーム11はダイクロイックミラー21を透過し、集光レンズ22により集光されてファイバグレーティング23の端面において収束する。

【0109】

このファイバグレーティング23は図21に詳しく示すように、クラッド23b内にそれよりも高屈折率のコア23cが埋め込まれてなり、そしてコア23cには複数の屈折率変化部が等間隔に形成された光ファイバーである。このファイバグレーティング23は、例えばクラッド外径が125 μm 、コア径が約10 μm の光通信用光ファイバーのコア23cに、紫外域の波長248 nmのエキシマレーザー光を用いて二光束干渉露光により干渉縞を形成させ、コア23cの光が照射された部分の屈折率を変化（上昇）させることにより作成される。なおこの屈折率変化は、コア23cにドーピングされている酸化ゲルマニウムが紫外線照射により化学変化を起こすことによって生じると考えられている。

【0110】

上記ファイバグレーティング23は、集光レンズ22を経たレーザービーム11の収束位置にコア端面23aが位置するように配設されている。そこでレーザービーム11はコア端面23aからコア23c内に入射し、そこを伝搬する。コア23cに形成された上記屈折率変化部は、レーザービーム11の伝搬方向に沿ったグレーティング（回折格子）を構成している。このグレーティングは、コア23cを伝搬する光ビームのうち、その周期 Λ_{FG} に対応した特定波長の光のみを反射回折させ、光波長変換素子15を介して半導体レーザー100にフィードバックさせる。つまりこの装置では、コア23cに形成されたグレーティングと半導体レーザー100の後方端面（図2

0 中の左方の端面) によって半導体レーザ100の外部共振器が構成されている。

【0 1 1 1】

したがって、上記グレーティングの周期 Λ_{FG} を所定値に設定しておくことにより、半導体レーザ100の発振波長を、ドメイン反転部17の周期と位相整合する波長に選択、ロックすることができる。

【0 1 1 2】

次に図22を参照して、本発明の第16の実施形態について説明する。この第16の実施形態の光波長変換モジュールにおいて、第2高調波19はダイクロイックミラー30を透過して利用位置に導かれ、レーザビーム11はこのダイクロイックミラー30で反射してファイバグレーティング23に導かれる。

【0 1 1 3】

この場合も、ファイバグレーティング23のコアに形成されたグレーティングと半導体レーザ100の後方端面(図22中の左方の端面)によって半導体レーザ100の外部共振器が構成され、図20の装置におけるのと同様の効果が得られる。

【0 1 1 4】

次に図23を参照して、本発明の第17の実施形態について説明する。この第17の実施形態の光波長変換モジュールは、図20のものと比べると、波長変換されなかったレーザビーム11と第2高調波19とを分離する手段が異なるものである。すなわち本装置においては、ファイバグレーティング33として、前述と同様の屈折率変化部を有する第1のファイバー34と、この第1のファイバー34に結合された第2のファイバー35とからなるものが用いられている。これら第1のファイバー34および第2のファイバー35は、波長選択ファイバーカップラを構成している。

【0 1 1 5】

光波長変換素子15から発散光状態で出射したレーザビーム11および第2高調波19は、収束光学系としての集光レンズ31により収束せしめられる。この収束位置には、ファイバグレーティング33の第2のファイバー35の一端面が配されており、レーザビーム11および第2高調波19はこの第2のファイバー35に入射する。この第2のファイバー35に入射してそこを伝搬した第2高調波19は、該第2のフ

ファイバー35の他端面から発散光状態で出射し、コリメーターレンズ20によって平行光化された上で、利用位置に導かれる。

【 0 1 1 6 】

一方、第2のファイバー35に入射してそこを伝搬したレーザービーム11は、両ファイバー34、35の結合部分において第1のファイバー34の方に移り、該第1のファイバー34を伝搬してその屈折率変化部において反射回折する。反射回折したレーザービーム11は、第2のファイバー35および光波長変換素子15を介して半導体レーザー100にフィードバックされ、そこでこの場合も図20の装置におけるのと同様の効果が得られることになる。

【 0 1 1 7 】

なお上記とは反対に、集光レンズ31により収束したレーザービーム11および第2高調波19をまず第1のファイバー34に入射させ、該第1のファイバー34を伝搬する第2高調波19を第2のファイバー35の方に移すようにしてもよい。

【 0 1 1 8 】

以上説明した第15、16および17の実施形態はいずれも、光波長変換素子15から波長変換されずに出射した基本波としてのレーザービーム11をファイバークレーティングにより反射回折させるものであるが、次に、光波長変換素子15に入射する前のレーザービーム11をファイバークレーティングにより反射回折させるようにした3つの実施形態について説明する。

【 0 1 1 9 】

図24は、本発明の第18の実施形態による光波長変換モジュールを示すものである。この光波長変換モジュールにおいて、半導体レーザー100から発散光状態で出射したレーザービーム11は、収束光学系としての集光レンズ40により収束せしめられる。この収束位置には、図20の装置で用いられたものと同様のファイバークレーティング23の一端面が配されており、レーザービーム11はこのファイバークレーティング23に入射する。

【 0 1 2 0 】

ファイバークレーティング23を伝搬したレーザービーム11の一部は、該ファイバークレーティング23の屈折率変化部において反射回折する。反射回折したレーザー

ビーム11は、集光レンズ40を介して半導体レーザ100にフィードバックされ、そこでこの場合も図20の装置におけるのと同様の効果が得られることになる。

【0121】

一方、ファイバグレーティング23を伝搬してその他端面から出射したレーザビーム11は、集光レンズ41により集光されて光波長変換素子15のチャンネル光導波路18に入射し、そこで第2高調波19に波長変換される。光波長変換素子15から発散光状態で出射した第2高調波19およびレーザビーム11は、コリメーターレンズ20によって平行光化され、第2高調波19が利用位置に導かれる。この第2高調波19をレーザビーム11から分離させるには、既に説明したようなものを適宜用いればよい。

【0122】

次に図25を参照して、本発明の第19の実施形態について説明する。この第19の実施形態の光波長変換モジュールにおいては、コリメーターレンズ12によって平行光化されたレーザビーム11がビームスプリッタ45によって分岐される。すなわち、このビームスプリッタ45を透過したレーザビーム11は、図20の装置におけるのと同様にして光波長変換素子15に導かれる。他方、このビームスプリッタ45で反射したレーザビーム11はミラー46で反射した後、集光レンズ22で集光されてファイバグレーティング23に入射する。

【0123】

ファイバグレーティング23に入射してそこを伝搬したレーザビーム11は、該ファイバグレーティング23の屈折率変化部において反射回折する。反射回折したレーザビーム11は、ミラー46やビームスプリッタ45等を介して半導体レーザ100にフィードバックされ、そこでこの場合も図20の装置におけるのと同様の効果が得られる。

【0124】

なおこの実施形態においては、コリメーターレンズ12および集光レンズ22により、光波長変換素子15に入射する前のレーザビーム11を収束させる収束光学系が構成されている。

【0125】

次に図 2 6 を参照して、本発明の第 2 0 の実施形態について説明する。この第 2 0 の実施形態の光波長変換モジュールは、前述した図 2 4 の光波長変換モジュールと比べると、ファイバグレーティング 23 に代えて、ファイバカップラを構成するファイバグレーティング 50 が用いられている点が異なるものである。このファイバグレーティング 50 は、屈折率変化部を有する第 1 のファイバ 51 と、該第 1 のファイバ 51 に結合された第 2 のファイバ 52 とからなるものである。

【 0 1 2 6 】

上記第 2 のファイバ 52 に入射してそこを伝搬するレーザビーム 11 は、一部が両ファイバ 51、52 の結合部分において第 1 のファイバ 51 の方に移って、二系統に分岐される。第 2 のファイバ 52 を伝搬してその他端面から出射したレーザビーム 11 は、集光レンズ 41 により集光されて光波長変換素子 15 のチャンネル光導波路 18 に入射し、そこで第 2 高調波 19 に波長変換される。光波長変換素子 15 から発散光状態で出射した第 2 高調波 19 およびレーザビーム 11 は、コリメーターレンズ 20 によって平行光化され、第 2 高調波 19 が利用位置に導かれる。この第 2 高調波 19 をレーザビーム 11 から分離させるには、既に説明したようなものを適宜用いればよい。

【 0 1 2 7 】

一方、第 1 のファイバ 51 に移ったレーザビーム 11 は、該第 1 のファイバ 51 を伝搬してその屈折率変化部において反射回折する。反射回折したレーザビーム 11 は、集光レンズ 40 を介して半導体レーザ 100 にフィードバックされ、そこでこの場合も図 2 0 の装置におけるのと同様の効果が得られることになる。

【 0 1 2 8 】

次に図 2 7 を参照して、半導体レーザ 100 の後方出射光を利用してその発振波長を選択、ロックするようにした本発明の第 2 1 の実施形態について説明する。この第 2 1 の実施形態の光波長変換モジュールにおいては、光波長変換素子 15 に向かわないレーザビーム 11 R（後方出射光）が、収束光学系としての集光グレーティング 23 に入射したレーザビーム 11 R は、該ファイバグレーティング 23 の屈折率変化部において反射回折する。反射回折したレーザビーム 11 R は、集光レンズ 60

を介して半導体レーザ100にフィードバックされ、そこでこの場合も図20の装置におけるのと同様の効果が得られる。

【0129】

以上説明した第2～21の実施形態においても、基本波光源として、第1の実施形態で用いられたものと同様の半導体レーザ、すなわちMQW活性層125の3つの量子井戸層の厚みがそれぞれ互いに異なる半導体レーザ100が用いられていることにより、MQW活性層125の全体の利得スペクトルが拡大し、より広い波長範囲において発振波長の選択、ロックが可能となっている。

【0130】

なお以上説明した第1～21の実施形態においては全て、MgO-LNのインゴット16'を、Y軸をYZ面内でZ軸側に3°回転させた軸に対して垂直な面でカット、研磨して得られたMgO-LN基板(3°Yカット基板)16が用いられているが、本発明ではそれ以外の方位でカットされた基板を用いることも可能である。例えば図28に示すように、MgO-LNのインゴット16''を、そのZ軸をZX面内でX軸側に87°回転させた軸Z''に垂直となる面でカット、研磨して得た基板(87°Zカット基板)も好適に用いることができる。

【0131】

また、以上例示した基板は、その表面に平行な方向および垂直な方向に対して、それぞれZ軸およびY軸がオフセットしているものであるが、少なくともZ軸がオフセットしていれば同様の効果が得られるものである。

【0132】

次に図29を参照して、本発明の第22の実施形態について説明する。この第22の実施形態の光波長変換モジュールは、図9に示した光波長変換モジュールと比べると基本的に、半導体レーザ100'が光波長変換素子15の端面に直接結合されている点異なるものであり、半導体レーザ100'の発振波長の選択、ロックは図9の光波長変換モジュールにおけるのと同様にしてなされる。

【0133】

基本横モードの半導体レーザ100'の発振光の近視野像と、導波路型光波長変換素子15における導波光の電界分布とは互いに比較的近い形状となっているので

、レンズ光学系を用いなくても、半導体レーザ100'の発振光と導波光とを60～80%程度以上の高い効率で結合することが可能である。

【0134】

なお本実施形態で用いられている半導体レーザ100'は、基本的な構造は第1～21の実施形態において用いられた半導体レーザ100と同様のものであるが、そのMQW活性層125'は、 $\text{GaAs}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 障壁層(9nm)、 $\text{In}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{As}$ 量子井戸層(5nm)、 $\text{In}_{0.13}\text{Ga}_{0.87}\text{As}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 障壁層(4nm)、 $\text{In}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{As}$ 量子井戸層(6nm)、 $\text{In}_{0.13}\text{Ga}_{0.87}\text{As}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 障壁層(4nm)、 $\text{In}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{As}$ 量子井戸層(7nm)および $\text{GaAs}_{0.75}\text{P}_{0.25}$ 障壁層(9nm)を有する3重量子井戸構造のものであって、第1番目と第3番目の量子井戸層の厚みが前述の半導体レーザ100におけるのとは異なっている。しかしこの場合も、3重量子井戸構造を構成する3つの量子井戸層の厚みが互いに異なっていることから、MQW活性層125'の全体の利得スペクトルが拡大し、より広い波長範囲において発振波長の選択、ロックが可能となっている。

【0135】

次に図30を参照して、本発明の第23の実施形態について説明する。この第23の実施形態の光波長変換モジュールは、図27に示した光波長変換モジュールと比べると基本的に、半導体レーザ100が光波長変換素子15の端面に直接結合されている点が異なるものであり、半導体レーザ100の発振波長の選択、ロックは図27の光波長変換モジュールにおけるのと同様にしてなされる。

【0136】

次に図31を参照して、本発明の第24の実施形態について説明する。この第24の実施形態の光波長変換モジュールは、図30に示した光波長変換モジュールと比べると基本的に、波長選択光学素子であるファイバグレーティング23が半導体レーザ100の後方端面に直接結合されている点が異なるものであり、半導体レーザ100の発振波長の選択、ロックは図30の光波長変換モジュールにおけるのと同様にしてなされる。

【0137】

次に図 3 2 を参照して、本発明の第 2 5 の実施形態について説明する。この第 2 5 の実施形態の光波長変換モジュールは、図 3 1 に示した光波長変換モジュールと比べると基本的に、ファイバグレーティング 23 に代えて導波路型の波長選択光学素子 200 が用いられた点が異なるものである。この波長選択光学素子 200 は、例えば MgO がドーピングされた LiNbO_3 の結晶からなる基板 201 にチャンネル光導波路 202 が形成され、そしてこのチャンネル光導波路 202 に沿って DBR グレーティング 203 が形成されてなるものである。

【 0 1 3 8 】

本例では、半導体レーザ 100 の光波長変換素子 15 側の端面 100 e に反射率 30 % 程度のコートが形成され、導波路型の波長選択光学素子 200 の半導体レーザ 100 側の端面 200 b には、反射率 0.1 % 以下程度の低反射コートが形成されている。また、半導体レーザ 100 の波長選択光学素子 200 側の端面 100 d にも、反射率 0.1 % 以下程度の低反射コートが形成されている。

【 0 1 3 9 】

このような構成の場合、半導体レーザ 100 はファブリペロモードでは発振せず、波長選択光学素子 200 を外部共振器の片側の共振器ミラーとして発振するようになる。なお、波長選択光学素子 200 の端面 200 a にはほとんど光が到達しないが、この端面 200 a に反射率 0.1 ~ 1 % 程度以下の低反射コートを施しておけば、不要反射の影響を防止できる。

【 0 1 4 0 】

本実施形態の光波長変換モジュールにおいて、半導体レーザ 100 の後方端面（図 3 2 中の左端面）100 d から出射した後方出射光は、波長選択光学素子 200 のチャンネル光導波路 202 に入射してそこを導波モードで伝搬し、DBR グレーティング 203 で反射回折して半導体レーザ 100 に戻る。このとき、DBR グレーティング 203 の波長選択作用により、反射回折するレーザビームの波長が選択される。このように波長選択されたレーザビームが半導体レーザ 100 にフィードバックすることにより、該半導体レーザ 100 の発振波長が選択、ロックされるので、安定した出力の第 2 高調波 19 を得ることができる。

【 0 1 4 1 】

以上説明した第 2 3、2 4 および 2 5 の実施形態においても、基本波光源として、MQW 活性層 125 の 3 つの量子井戸層の厚みがそれぞれ互いに異なる半導体レーザ 100 が用いられていることにより、MQW 活性層 125 の全体の利得スペクトルが拡大し、より広い波長範囲において発振波長の選択、ロックが可能となっている。

【0 1 4 2】

次に図 3 3 を参照して、本発明の第 2 6 の実施形態について説明する。同図に平面形状を示すこの第 2 6 の実施形態の光波長変換モジュールは、図 3 2 に示した光波長変換モジュールと比較すると、半導体レーザ 100、光波長変換素子 15 および波長選択光学素子 200 の配置関係が異なるものであり、ここでは、光波長変換素子 15 が半導体レーザ 100 と波長選択光学素子 200 との間に配設されている。

【0 1 4 3】

この場合、半導体レーザ 100 が発する基本波としてのレーザビームの波長に対して、該半導体レーザ 100 の光波長変換素子 15 側の端面およびそれと反対側の端面にはそれぞれ L R（低反射）コート、H R（高反射）コートが、光波長変換素子 15 の両端面にはともに A R（無反射）コートが、そして波長選択光学素子 200 の光波長変換素子 15 側の端面およびそれと反対側の端面にはそれぞれ A R コート、A R コートが施されている。

【0 1 4 4】

このような構成においても、波長選択光学素子 200 に入射した基本波の一部がそこで波長選択されつつ反射回折して半導体レーザ 100 に戻り、それにより半導体レーザ 100 の発振波長が選択、ロックされるので、安定した出力の第 2 高調波を得ることができる。

【0 1 4 5】

次に図 3 4 を参照して、本発明の第 2 7 の実施形態による光波長変換モジュールについて説明する。同図に平面形状を示すこの第 2 7 の実施形態の光波長変換モジュールも、図 3 2 に示した光波長変換モジュールと比較すると、半導体レーザ 100、光波長変換素子 15 および波長選択光学素子 200 の配置関係が異なるものであり、ここでは、波長選択光学素子 200 が半導体レーザ 100 と光波長変換素子 15 との間に配設されている。

【 0 1 4 6 】

この場合、半導体レーザ100が発する基本波としてのレーザビームの波長に対して、該半導体レーザ100の波長選択光学素子200側の端面およびそれと反対側の端面にはそれぞれLRコート、HRコートが、波長選択光学素子200の両端面にはともにARコートが、そして光波長変換素子15の両端面にはともにARコートが施されている。なお半導体レーザ100の波長選択光学素子200側の端面には、LRコートの代わりにARコートを施してもよい。

【 0 1 4 7 】

このような構成においても、波長選択光学素子200に入射した基本波の一部がそこで波長選択されつつ反射回折して半導体レーザ100に戻り、それにより半導体レーザ100の発振波長が選択、ロックされるので、安定した出力の第2高調波を得ることができる。

【 0 1 4 8 】

次に図35を参照して、本発明の第28の実施形態による光波長変換モジュールについて説明する。同図に平面形状を示すこの第28の実施形態の光波長変換モジュールにおいては、図35に示した光波長変換モジュールと同様に、半導体レーザ100が波長選択光学素子200と光波長変換素子15との間に配設されている。

【 0 1 4 9 】

この場合、半導体レーザ100が発する基本波としてのレーザビームの波長に対して、該半導体レーザ100の両端面にはともにLRコートが、波長選択光学素子200の両端面にはともにARコートが、そして光波長変換素子15の両端面にはともにARコートが施されている。

【 0 1 5 0 】

この構成においては、半導体レーザ100から光波長変換素子15と反対側に出射したレーザビーム（後方出射光）が波長選択光学素子200で波長選択されつつ反射回折して半導体レーザ100に戻り、それにより半導体レーザ100の発振波長が選択、ロックされるので、安定した出力の第2高調波を得ることができる。

【 0 1 5 1 】

なお本実施形態では特に、波長選択光学素子200の半導体レーザ100と反対側の

端面200aが、該波長選択光学素子200の光導波路の延びる方向に対して斜めにカットされているので、この端面200aで反射した基本波が波長選択光学素子200の光導波路に再入射することがなくなる。そうであれば、この再入射した基本波が半導体レーザ100にいわゆる戻り光となって入射することがなくなるので、この戻り光によるノイズの発生や出力変動の問題を防止することができる。

【0152】

次に図36を参照して、本発明の第29の実施形態による光波長変換モジュールについて説明する。同図に平面形状を示すこの第29の実施形態の光波長変換モジュールは、透過型の波長選択光学素子210が半導体レーザ100と光波長変換素子15との間に配設されてなるものである。

【0153】

この実施形態において、半導体レーザ100が発する基本波としてのレーザビームの波長に対して、該半導体レーザ100の両端面にはともにLRコートが、波長選択光学素子210の両端面にはともにARコートが、そして光波長変換素子15の波長選択光学素子210側の端面にはARコートが、その反対側の端面にはHRコートが施されている。

【0154】

この構成において、波長選択光学素子210を透過して波長選択された基本波は、上記光波長変換素子15のHRコートが施された端面で反射して半導体レーザ100に戻る。それにより本例においても、半導体レーザ100の発振波長が選択、ロックされるので、安定した出力の第2高調波を得ることができる。

【0155】

以上説明した第26、27、28および29の実施形態においても、基本波光源として、MQW活性層の3つの量子井戸層の厚みがそれぞれ互いに異なる半導体レーザ100が用いられていることにより、MQW活性層全体の利得スペクトルが拡大し、より広い波長範囲において発振波長の選択、ロックが可能となっている。

【0156】

なお本発明の光波長変換モジュールにおいて用いられる半導体レーザは、先に説明した半導体レーザ100や半導体レーザ100'に限られるものではなく、その他

例えば、図 3 7 に示す半導体レーザ 300 等も適用可能である。この図 3 7 の半導体レーザ 300 はリッジ導波路型の基本横モードレーザであり、n-GaAs 基板 301、n-GaAs バッファ層 302、n-InGaP クラッド層 303、InGaAsP 光ガイド層 304、MQW 活性層 305、InGaAsP 光ガイド層 306、p-InGaP クラッド層 307、p-GaAs キャップ層 308、SiO₂ 層 309、p 側電極 310 および n 側電極 311 を備えてなる。

【 0 1 5 7 】

この種の半導体レーザにおいても、MQW 活性層 305 を構成する複数の量子井戸層のうちの少なくとも一つを、他の量子井戸層と組成および／または厚みが異なるようにしておけば、既述の各実施形態におけるのと同様の効果を得ることができる。

【 0 1 5 8 】

また、以上説明した各実施形態の光波長変換モジュールは、GaAs 基板を用いて形成された半導体レーザが発する中心波長 946 nm のレーザビームを波長 473 nm の第 2 高調波に波長変換するものであるが、本発明の光波長変換モジュールはそれに限らず、例えば GaAs 基板を用いて形成された半導体レーザが発するその他の波長帯 (630 ~ 1100 nm) のレーザビームや、InP 基板を用いて形成された半導体レーザが発する主に 1250 ~ 1700 nm 帯のレーザビームを波長変換するように構成することも勿論可能である。

【 0 1 5 9 】

さらに本発明の光波長変換モジュールにおいては、光導波路のドメイン反転部よりも導波方向上流側において、該光導波路を導波する光を変調する電気光学光変調部が形成されてもよい。このような電気光学光変調部を有する光波長変換モジュールについては、例えば本出願人による特開平 1 0 - 1 6 1 1 6 5 号公報に詳しい記載がなされている。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 1 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 2】

上記光波長変換モジュールの要部を示す斜視図

【図 3】

上記光波長変換モジュールに用いられた半導体レーザの断面模式図

【図 4】

上記第 1 実施形態の光波長変換モジュールに用いられた光波長変換素子を作成する様子を示す概略斜視図

【図 5】

上記光波長変換素子に用いられる基板のカット状態を説明する概略図

【図 6】

上記光波長変換素子に形成されるドメイン反転部を示す概略斜視図

【図 7】

本発明の第 2 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 8】

本発明の第 3 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 9】

本発明の第 4 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 1 0】

本発明の第 5 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 1 1】

本発明の第 6 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 1 2】

本発明の第 7 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 1 3】

本発明の第 8 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 1 4】

本発明の第 9 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 1 5】

本発明の第 1 0 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 1 6】

本発明の第 1 1 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 1 7】

本発明の第 1 2 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 1 8】

本発明の第 1 3 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 1 9】

本発明の第 1 4 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 2 0】

本発明の第 1 5 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 2 1】

上記第 1 5 実施形態による光波長変換モジュールの要部を示す概略側面図

【図 2 2】

本発明の第 1 6 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 2 3】

本発明の第 1 7 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 2 4】

本発明の第 1 8 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 2 5】

本発明の第 1 9 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 2 6】

本発明の第 2 0 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 2 7】

本発明の第 2 1 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 2 8】

本発明に用いられる光波長変換素子用基板の別のカット状態を説明する概略図

【図 2 9】

本発明の第 2 2 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 3 0】

本発明の第 2 3 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 3 1】

本発明の第 2 4 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 3 2】

本発明の第 2 5 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略側面図

【図 3 3】

本発明の第 2 6 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略平面図

【図 3 4】

本発明の第 2 7 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略平面図

【図 3 5】

本発明の第 2 8 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略平面図

【図 3 6】

本発明の第 2 9 実施形態による光波長変換モジュールを示す概略平面図

【図 3 7】

本発明の光波長変換モジュールに用いられる別の半導体レーザの断面模式図

【図 3 8】

本発明の効果を説明する説明図

【符号の説明】

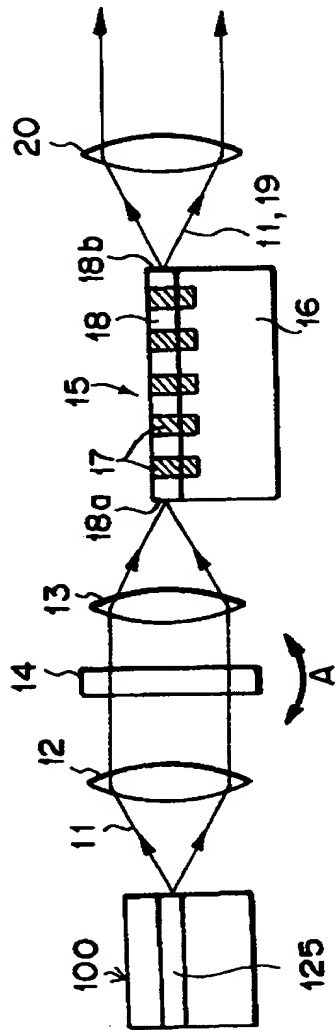
- 11 レーザビーム (基本波)
- 11R レーザビーム (後方出射光)
- 12 コリメーターレンズ
- 13 集光レンズ
- 14 狭帯域バンドパスフィルター
- 15 光波長変換素子
- 16 MgO-LN 結晶基板
- 17 ドメイン反転部
- 18 チャンネル光導波路
- 18a、18b チャンネル光導波路の端面
- 19 第 2 高調波
- 20 コリメーターレンズ
- 21 ダイクロイックミラー

- 22 集光レンズ
- 23 ファイバークレーティング
- 23 a ファイバークレーティングのコア端面
- 23 b ファイバークレーティングのコア
- 23 c ファイバークレーティングのクラッド
- 30 ダイクロイックミラー
- 31 集光レンズ
- 33 ファイバークレーティング
- 34 第 1 のファイバー
- 35 第 2 のファイバー
- 40、41 集光レンズ
- 45 ビームスプリッタ
- 46 ミラー
- 50 ファイバークレーティング
- 51 第 1 のファイバー
- 52 第 2 のファイバー
- 60 集光レンズ
- 80 楕形電極
- 81 平板電極
- 82 ビームスプリッタ
- 84 集光レンズ
- 85 ミラー
- 86 コリメーターレンズ
- 90 透過型バルクグレーティング
- 91 透過型狭帯域薄膜バンドパスフィルター
- 92 反射型バルクグレーティング
- 95 反射型狭帯域薄膜バンドパスフィルター
- 100 半導体レーザ
- 100 a、100 b、100 d、100 e 半導体レーザの端面

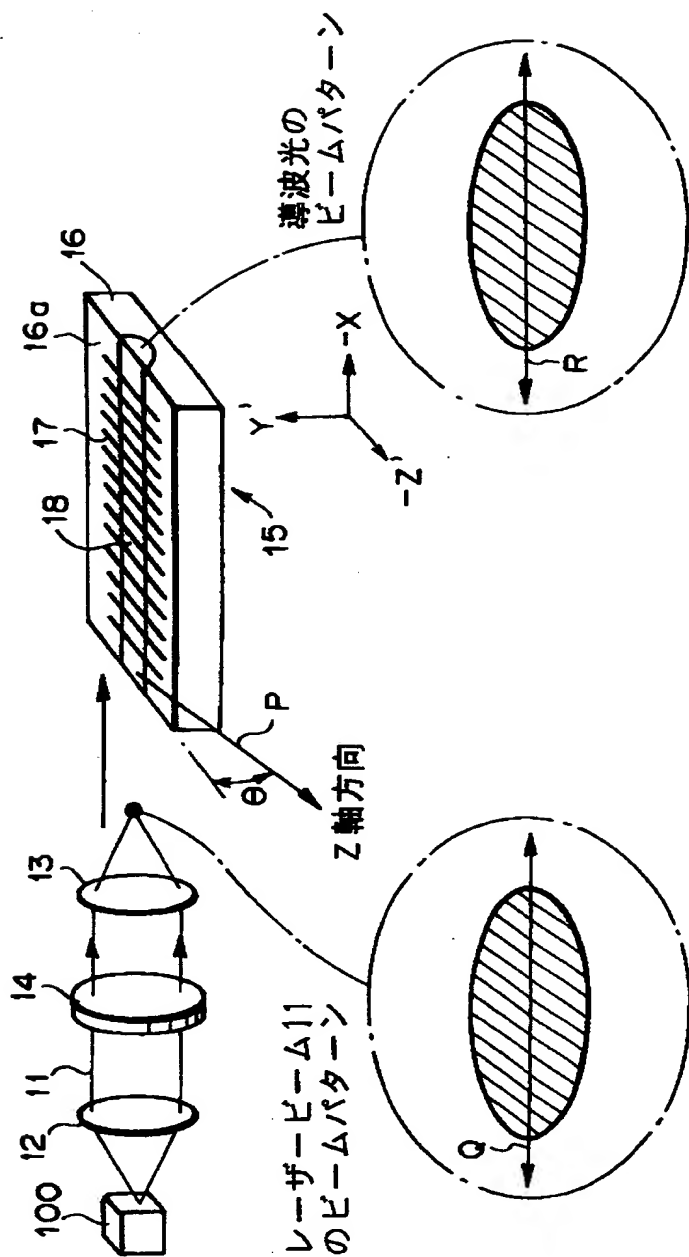
- 125 半導体レーザの多重量子井戸活性層
- 200、210 波長選択光学素子
- 202 波長選択光学素子のチャンネル光導波路
- 203 波長選択光学素子の D B R グレーティング
- 300 半導体レーザ
- 305 半導体レーザの多重量子井戸活性層

【書類名】 図面

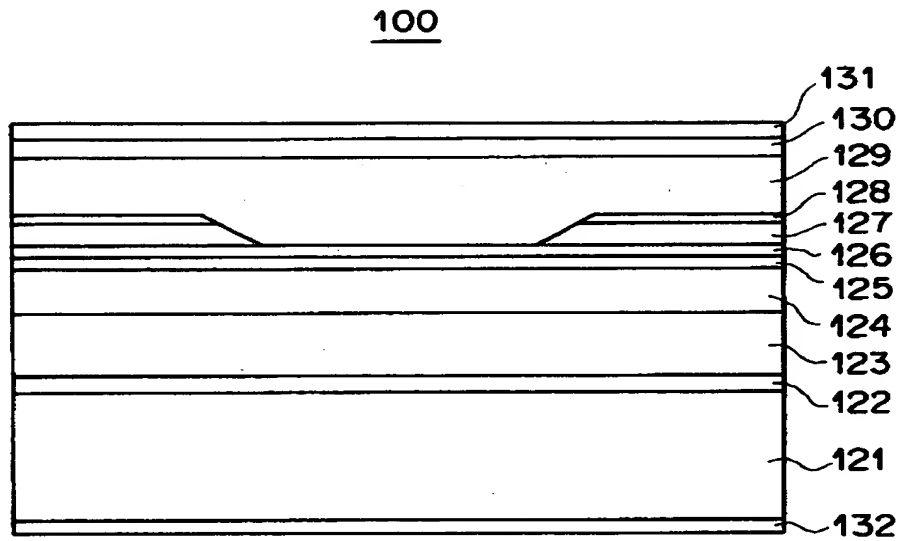
【図 1】



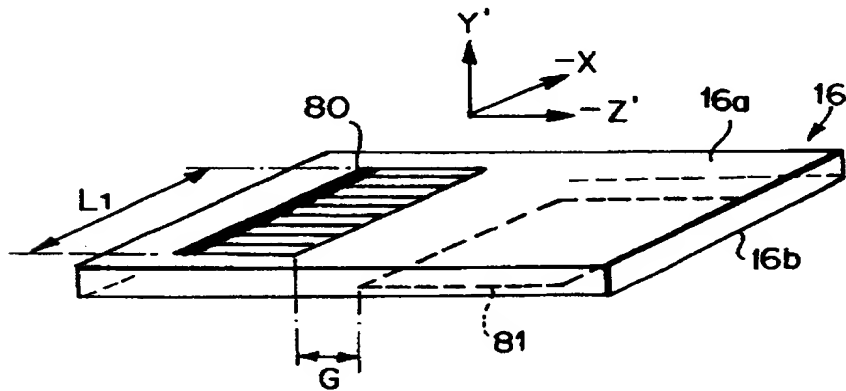
【図2】



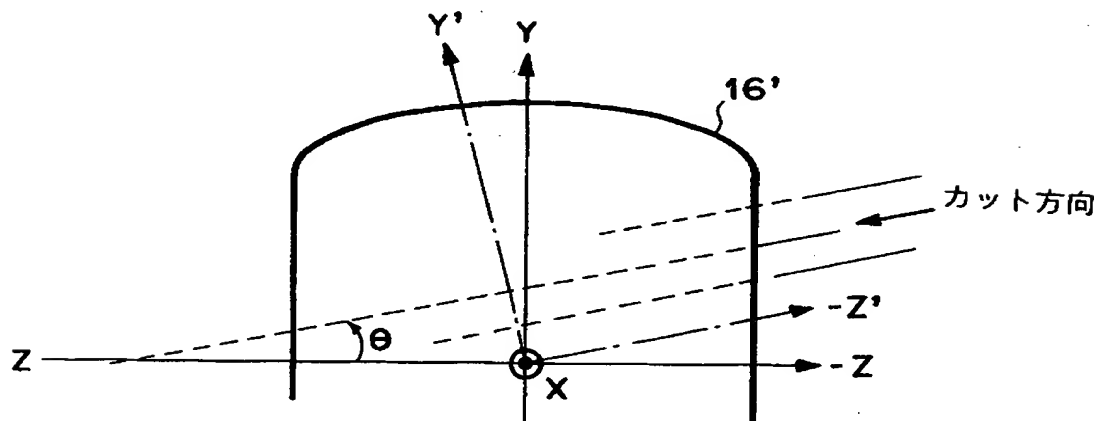
【図 3】



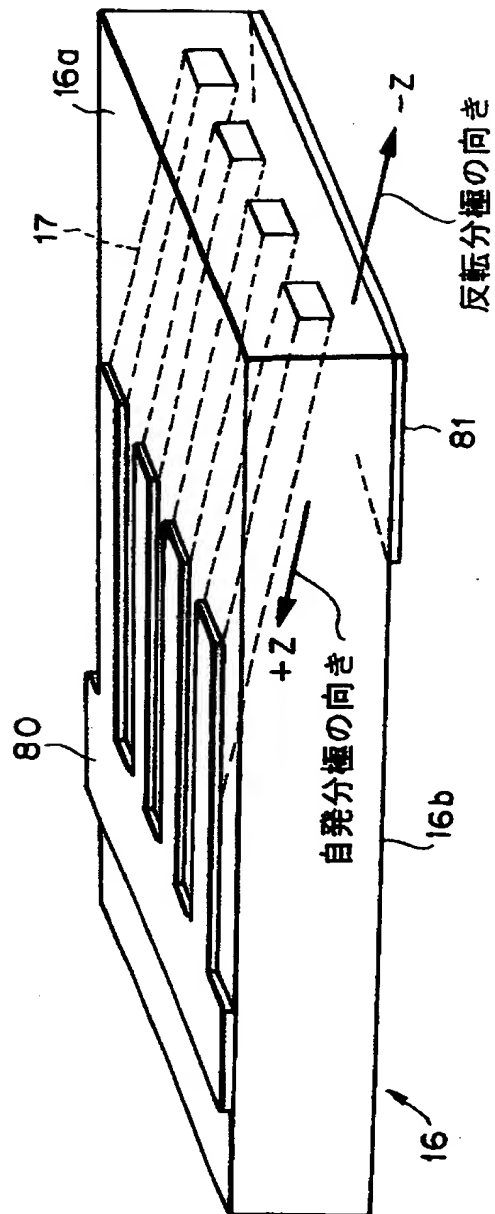
【図 4】



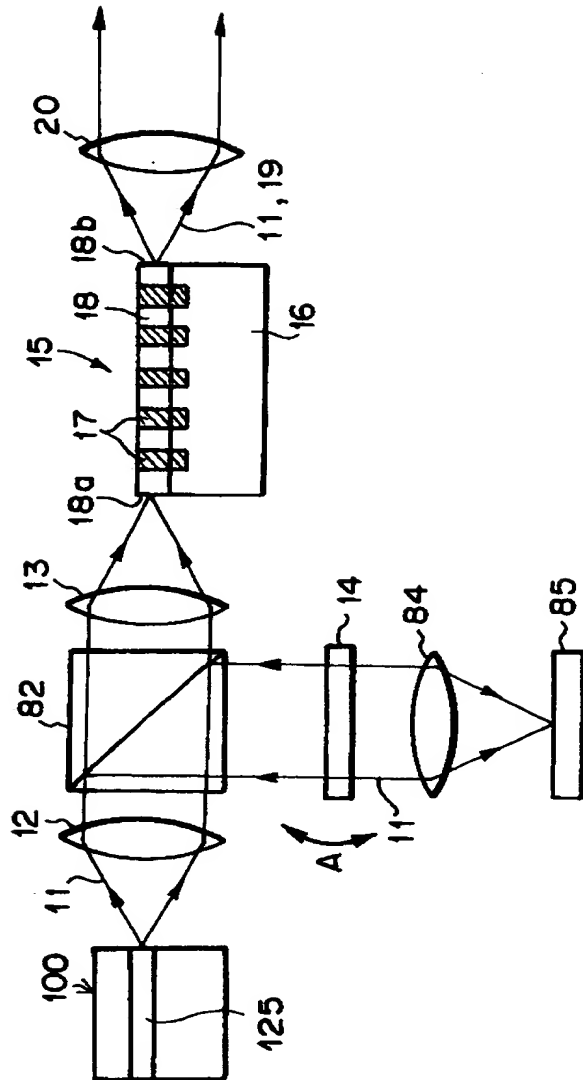
【図 5】



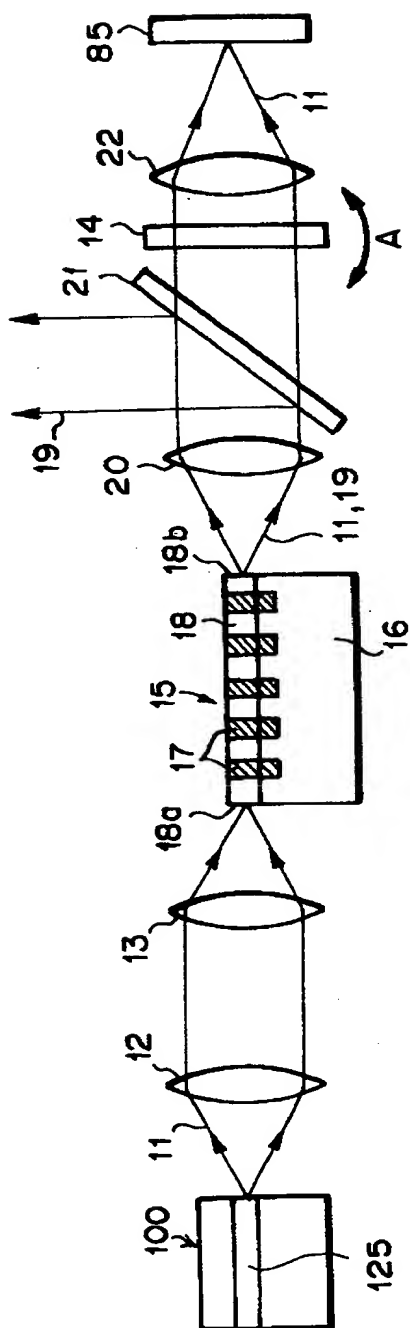
【図 6】



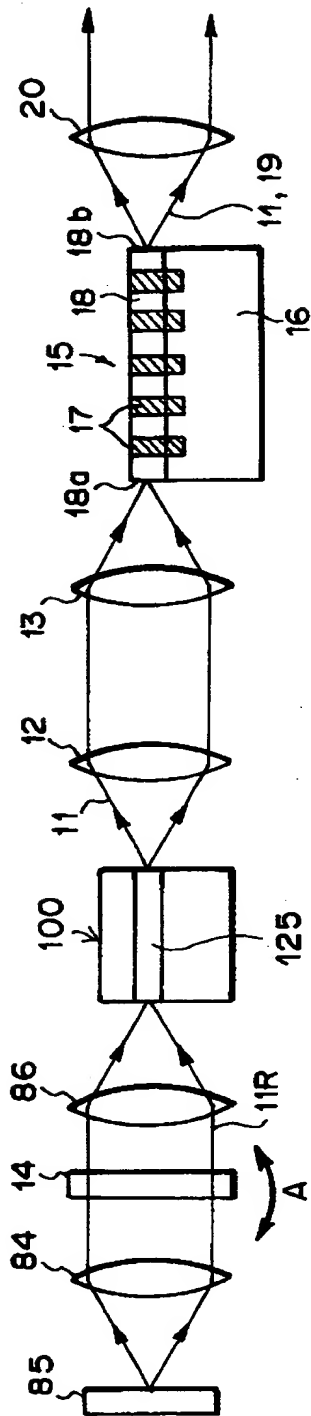
【図 7】



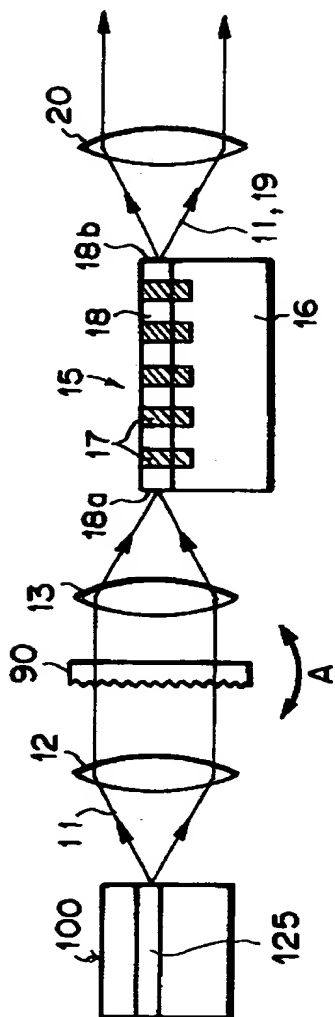
【図 8】



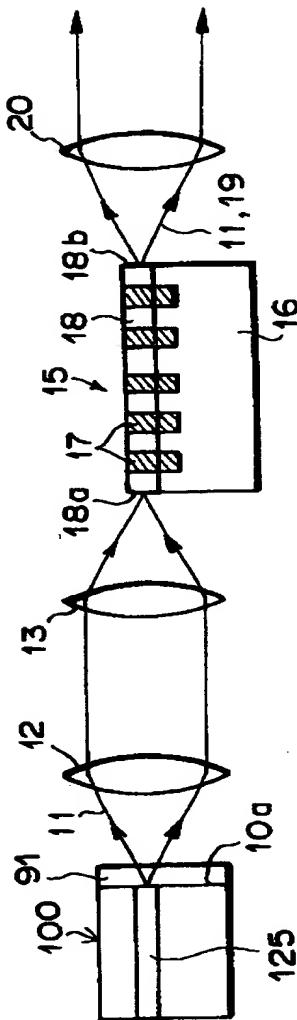
【図 9】



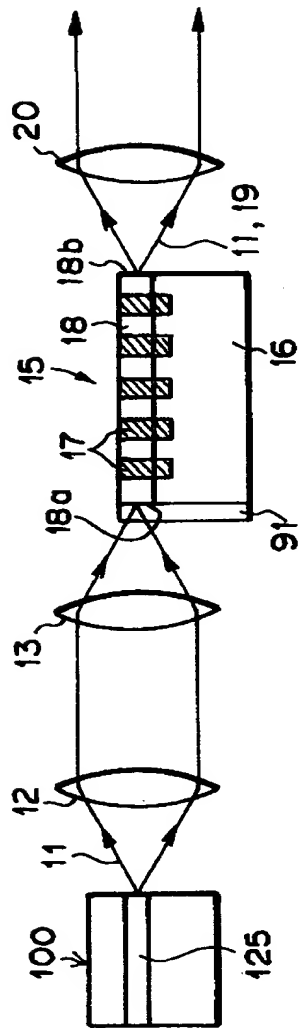
【図 1 0】



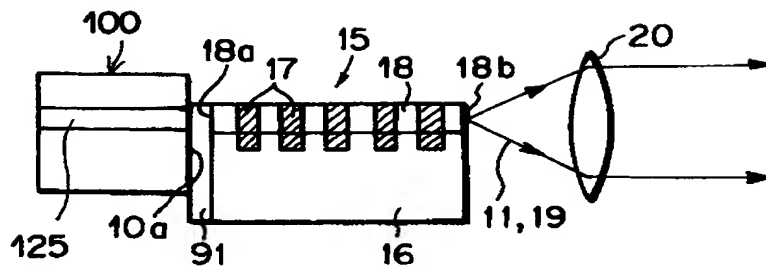
【図 1 1】



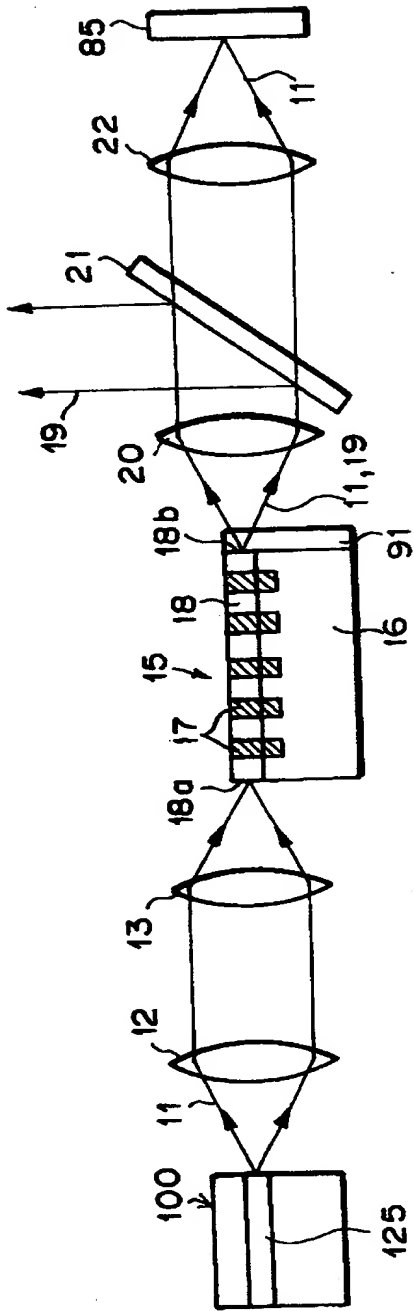
【図 1 2】



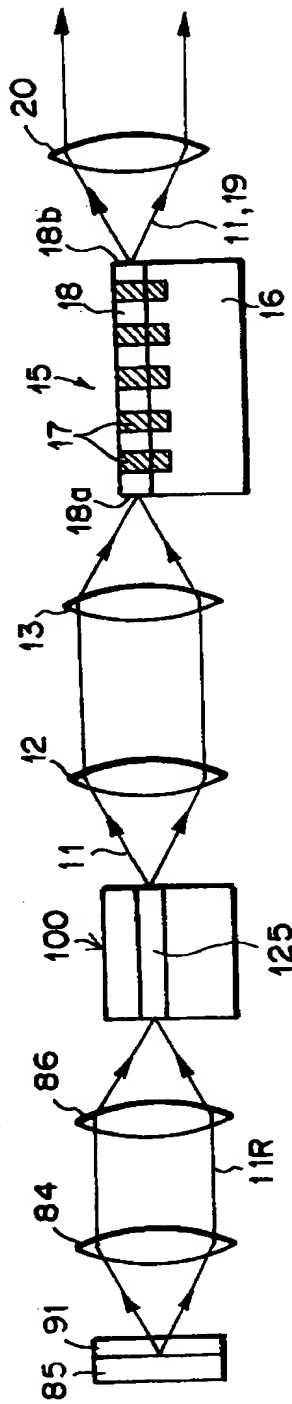
【図 1 3】



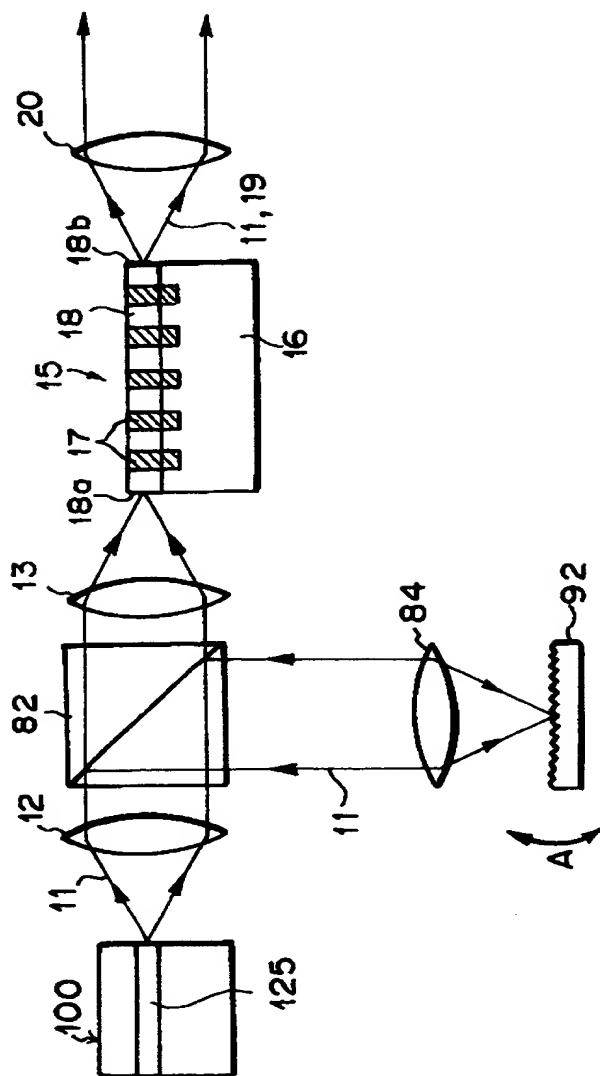
【図 1 4】



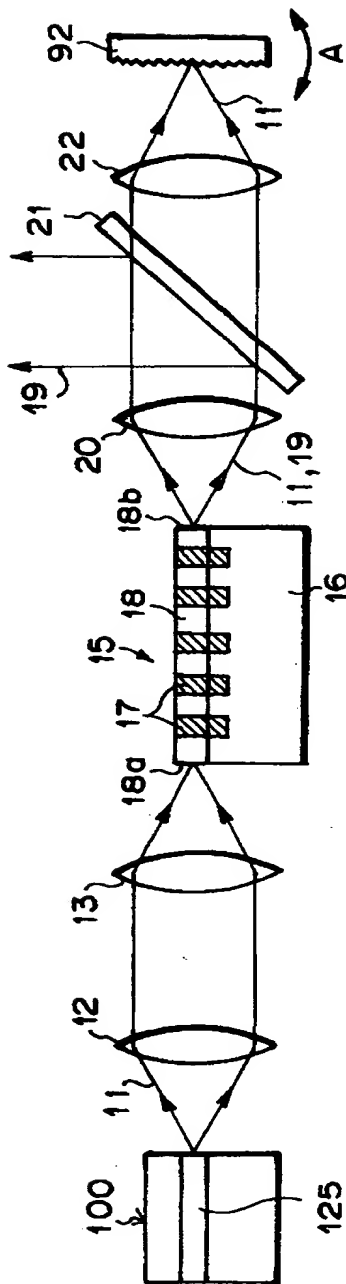
【図 15】



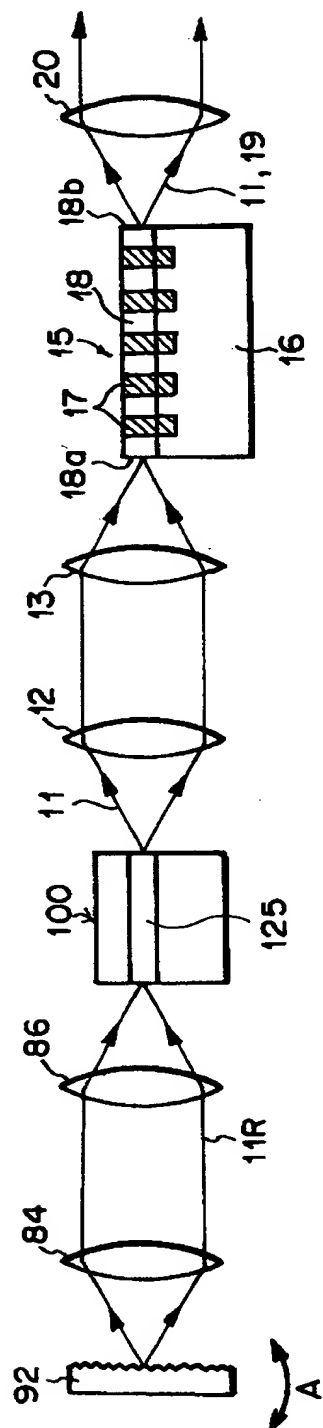
【図 1 6】



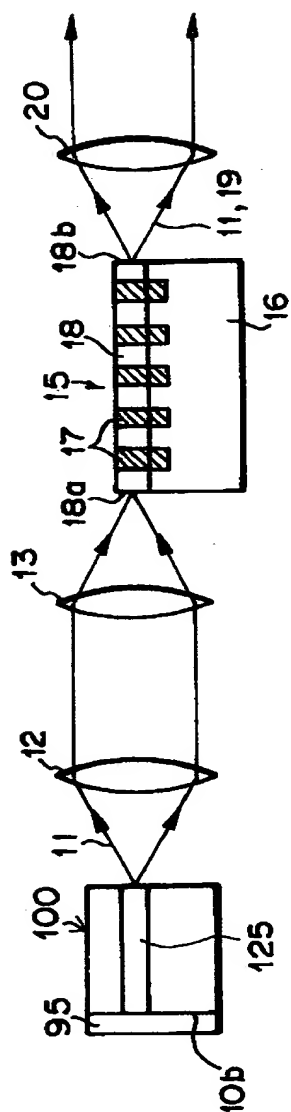
【図 1 7】



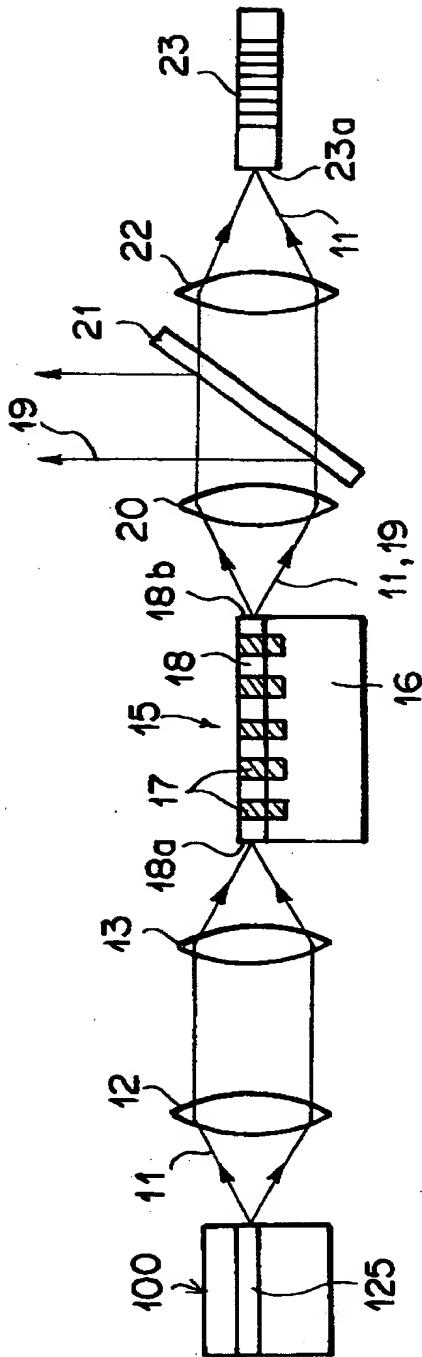
【図 1 8】



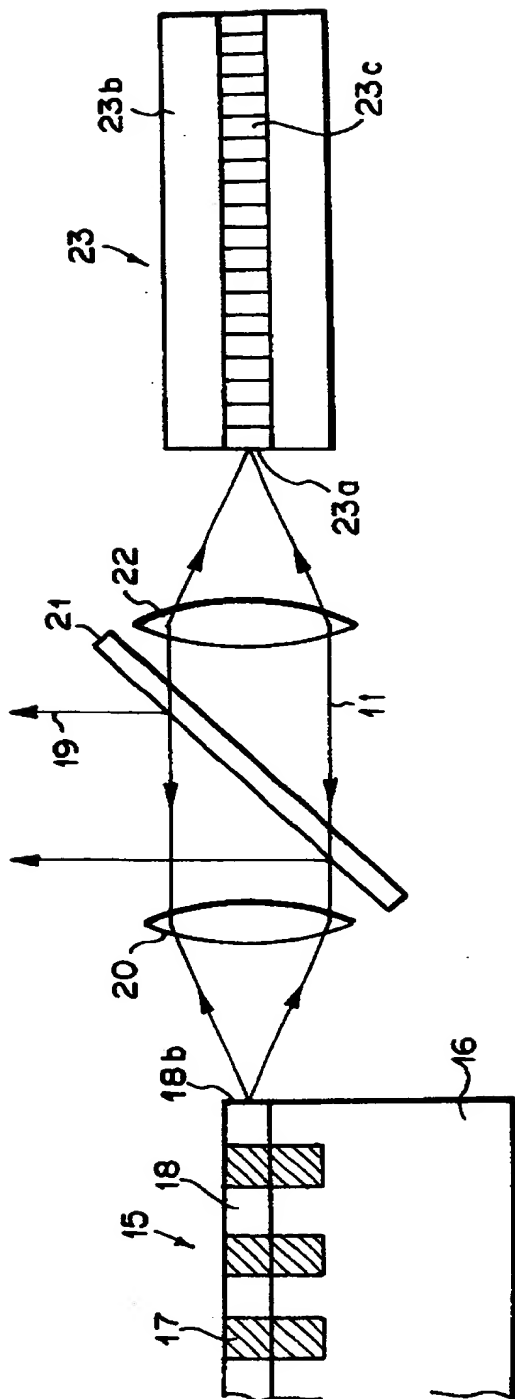
【図 1 9】



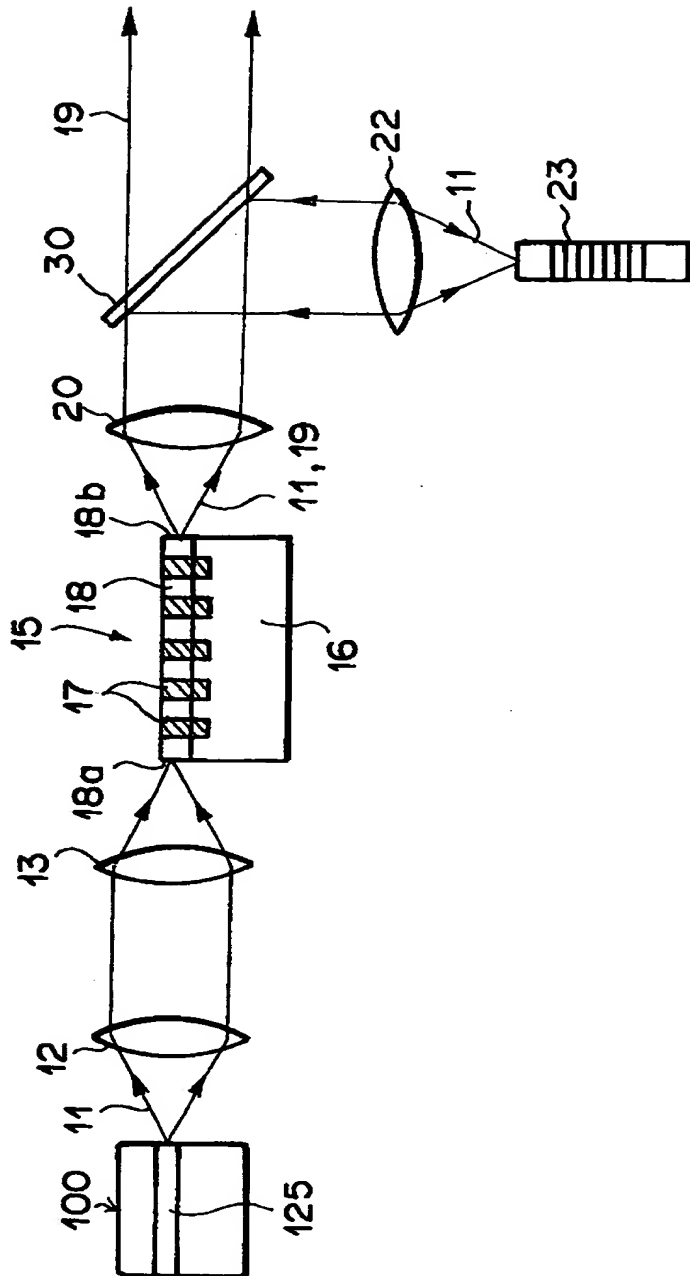
【図 20】



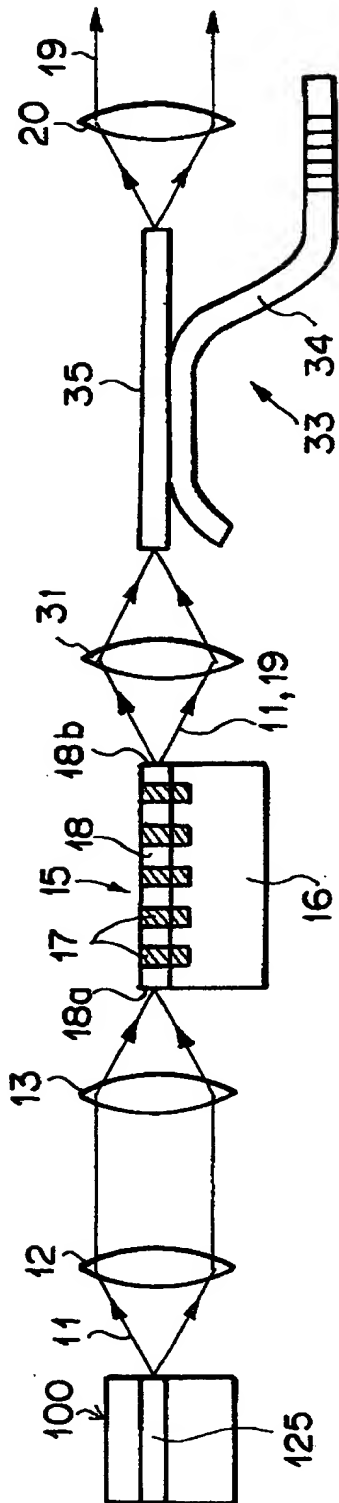
【図 2 1】



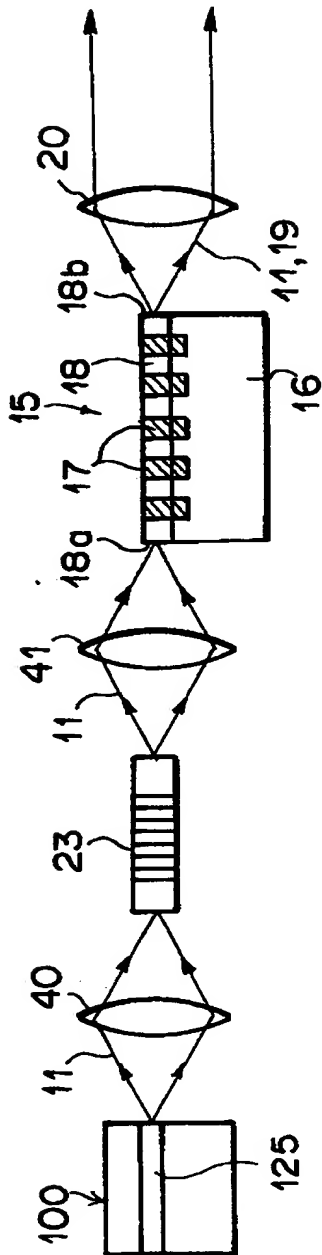
【図 22】



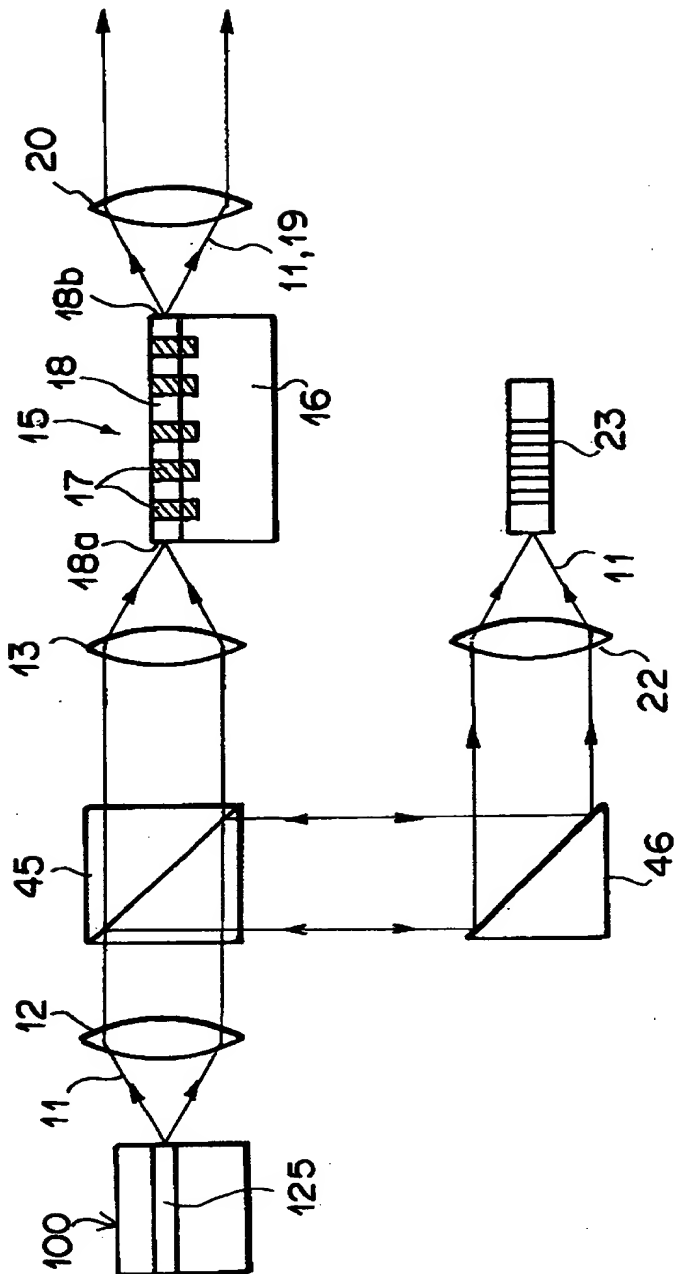
【図 2 3】



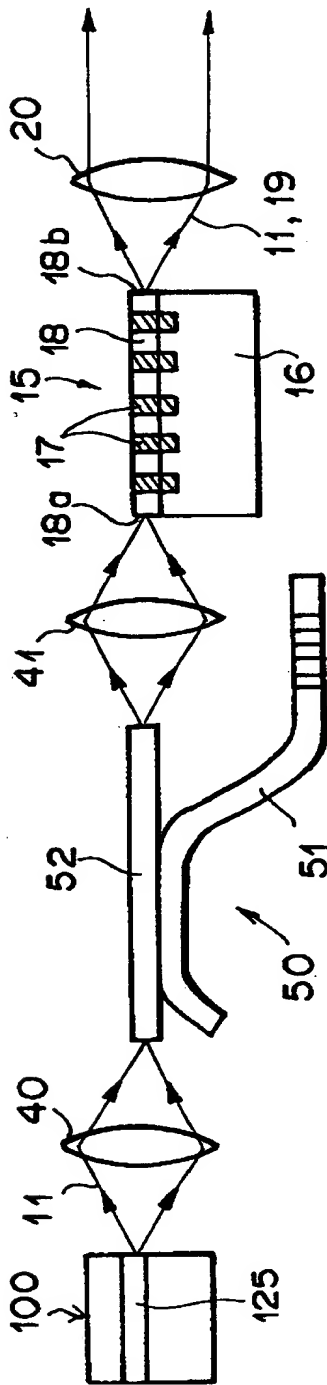
【図 2 4】



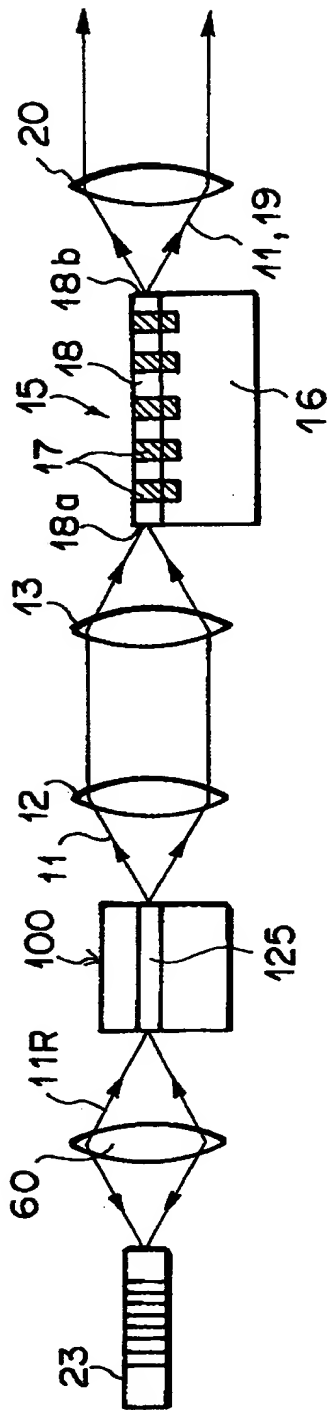
【図 2 5】



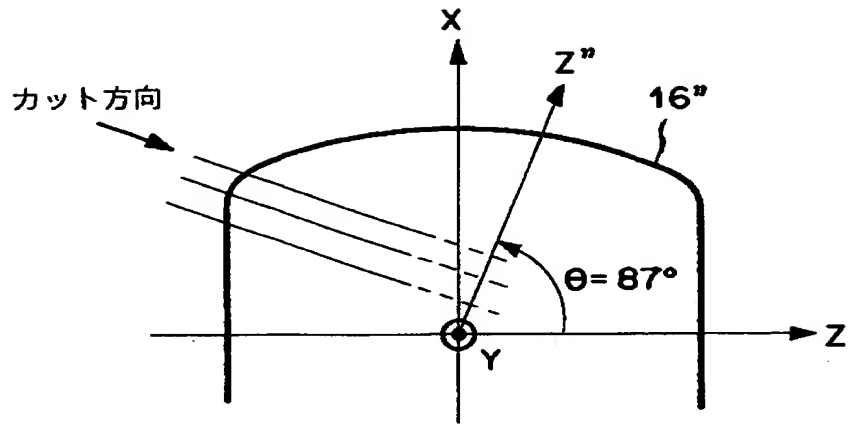
【図 26】



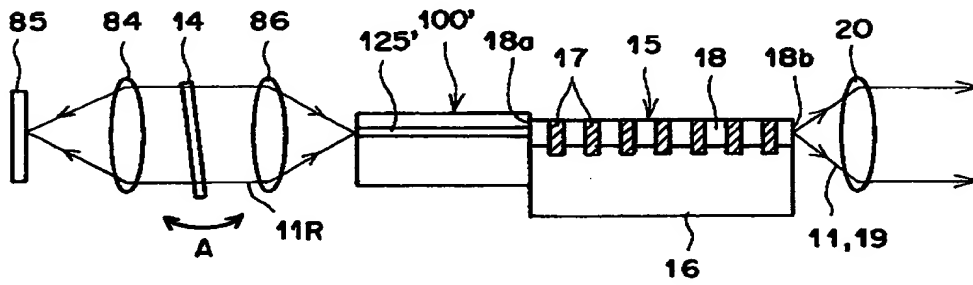
【図 27】



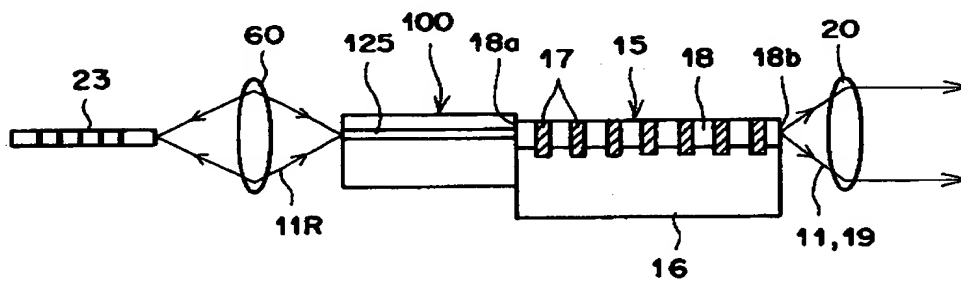
【図 28】



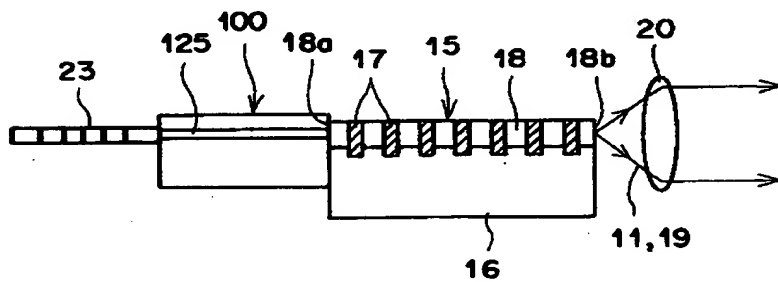
【図 29】



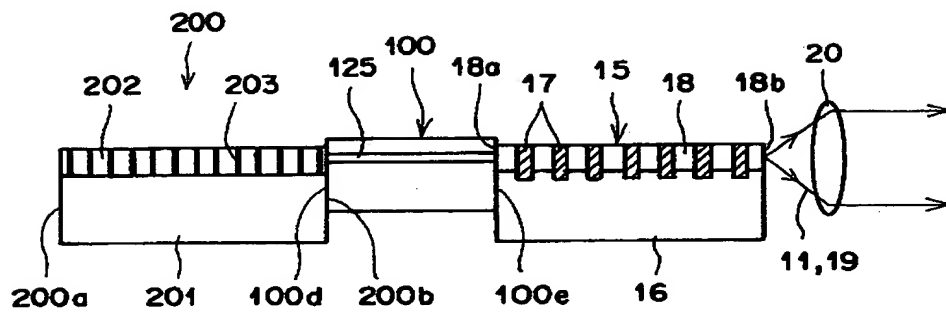
【図 30】



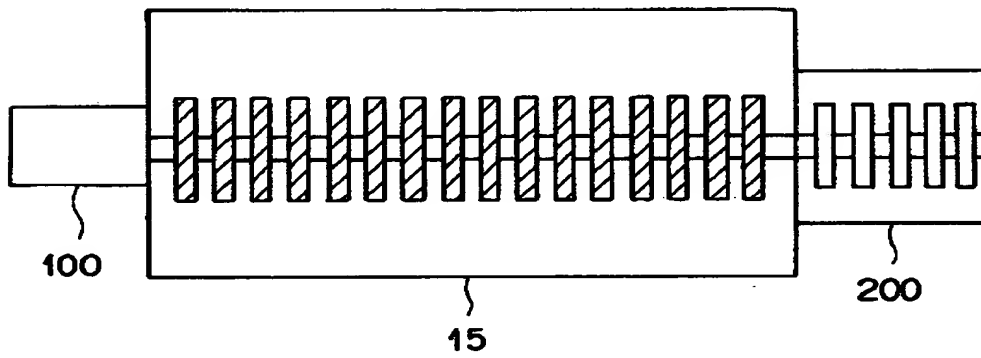
【図 31】



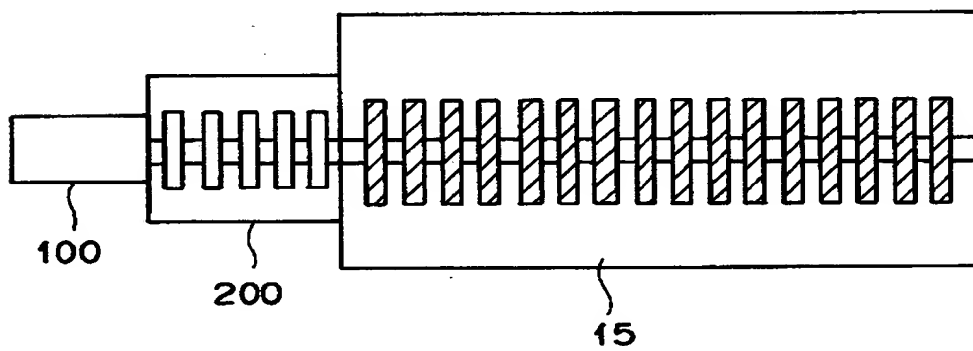
【図 3 2】



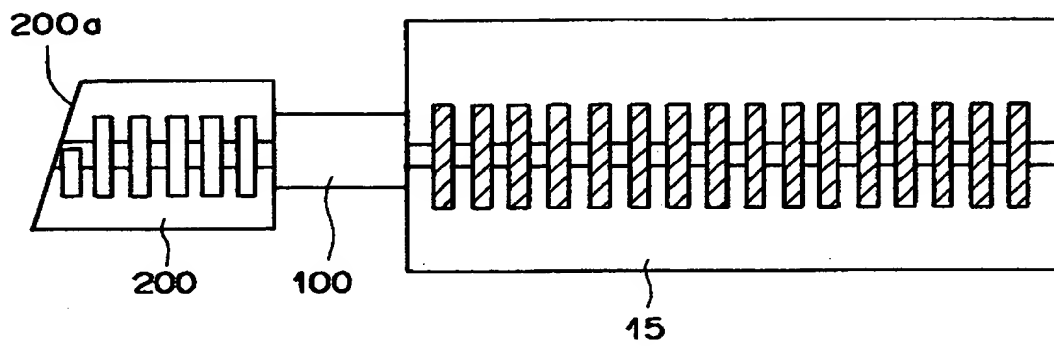
【図 3 3】



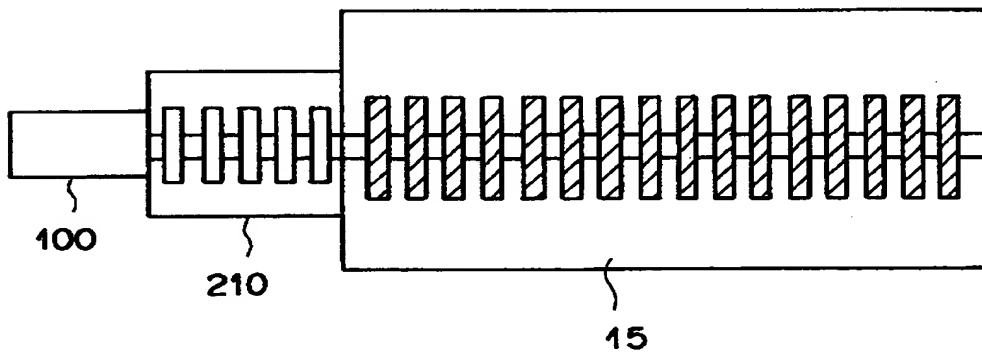
【図 3 4】



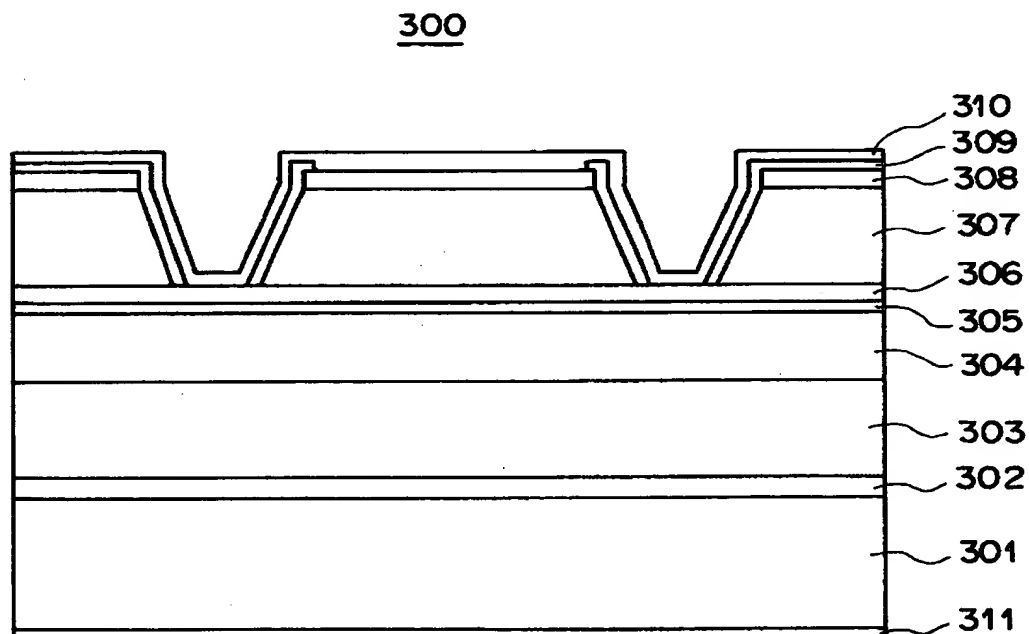
【図 3 5】



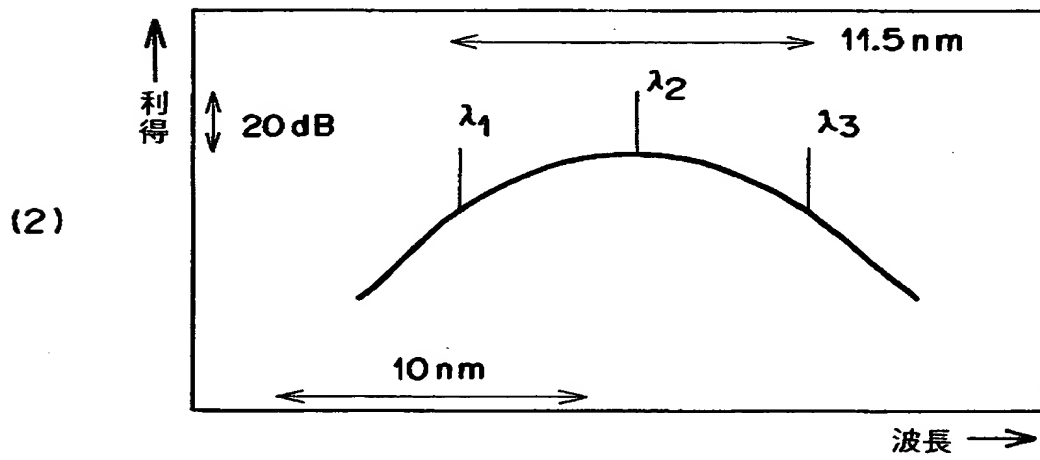
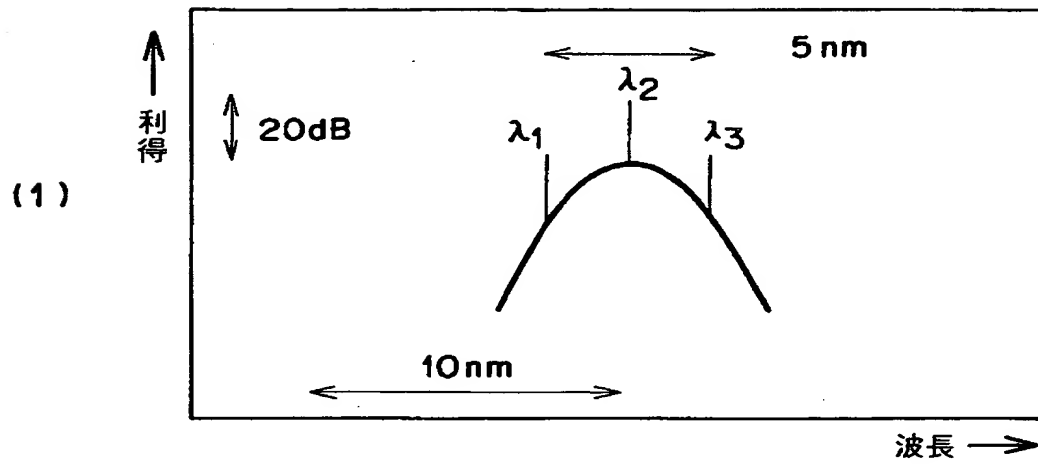
【図 3 6】



【図 3 7】



【図 3 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 半導体レーザから発せられた基本波を導波路型の光波長変換素子により波長変換し、そして該半導体レーザの発振波長を選択、ロックする構成を有する光波長変換モジュールにおいて、半導体レーザの波長ロック可能な範囲を拡大させる。

【解決手段】 光導波路型の光波長変換素子15と、この光波長変換素子15に入射される基本波としてのレーザビーム11を発する半導体レーザ100と、この半導体レーザ100から発せられた後該半導体レーザ100にフィードバックされるレーザビーム11を波長選択する狭帯域バンドパスフィルター等の波長選択光学素子14とからなる光波長変換モジュールにおいて、半導体レーザ100として多重量子井戸活性層125を有するものを用い、この多重量子井戸活性層125を構成する複数の量子井戸層のうちの少なくとも一つを、他の量子井戸層と組成および／または厚みが異なるものとする。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2000-121981
受付番号	50000511690
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成12年 4月25日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成12年 4月24日
【特許出願人】	
【識別番号】	000005201
【住所又は居所】	神奈川県南足柄市中沼210番地
【氏名又は名称】	富士写真フイルム株式会社
【代理人】	申請人
【識別番号】	100073184
【住所又は居所】	神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 B ENEX S-1 7階 柳田国際特許事務所
【氏名又は名称】	柳田 征史
【選任した代理人】	
【識別番号】	100090468
【住所又は居所】	神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 B ENEX S-1 7階 柳田国際特許事務所
【氏名又は名称】	佐久間 剛

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005201]

1. 変更年月日 1990年 8月14日
[変更理由] 新規登録
住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地
氏 名 富士写真フイルム株式会社